(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号 特開2000-38420 (P2000-38420A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 8 F 210/06		C 0 8 F 210/06	4J026
4/642		4/642	4J028
255/00		255/00	4 J 1 0 0

		審查請求	未請求 請求項の数6 OL (全 26 頁)		
(21)出職番号	特顧平 10-210108	(71)出職人			
(22)出廣日	平成10年7月24日(1998.7.24)	出光石油化学株式会社 東京都港区芝五丁目6番1号			
		(72)発明者	町田 修司		
			千葉県市原市姉崎海岸1番地1		
		(72)発明者	南 裕		
			千葉県市原市姉崎海岸1番地1		
		(72)発明者	後藤 康博		
			千葉県市原市姉崎海岸1番地1		
		(74)代理人	100078732		
			弁理士 大谷 保		
		l l			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プロピレン系共重合体及びその製造方法

【課題】 成形加工性にすぐれ、透明性及び均一性を有

(57)【要約】 (修正有)

し、相溶化剤としても有用なプロピレン系共重合体 【解決手段】 プロピレンに由来する末端ビニル基とジ オレフィン由来の炭素一炭素二重結合を含む重合体であ って、(a) Mw1500~500000、(b) ジオ レフィンに由来する単位の含有量が0~20モル%、 (c) プロピレン以外の $C_2 \sim 20 \alpha$ ーオレフィン、環 状オレフィン及びスチレン系単量体に由来する単位の含 有量が0~50モル%以下(d)〔n〕(デカリン1/ g)とプロピレンに由来する末端ビニル基とジオレフィ ン由来の炭素-炭素二重結合の含有量の和〔C〕との積 [η]・[C]が0.01~5を満足するもの、及びこの プロピレン系共重合体にプロピレン等を共重合してな り、沸騰キシレン不溶部が1%以下、ゲルを実質的に含 有せず、上記プロピレン系共重合体の含有量が0.01~ 80重量%であるプロピレン系グラフト共重合体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともプロピレンに由来する末端ビ ニル基とジオレフィン由来の炭素=炭素二重結合を含む 重合体であって、次の (a) ~ (d)

(a) 重量平均分子量が1500~500000、

(b) ジオレフィンに由来する単位の含有量がOモル% を超え20モル%以下、(c)プロピレン以外の炭素数 2~20のαーオレフィン、環状オレフィン及びスチレ ン系単量体に由来する単位の含有量が0~50モル%以 シリットル/g) とプロピレンに由来する末端ビニル基 とジオレフィン由来の炭素-炭素二重結合の含有量の和 (C) との積〔η)·(C)が0.01~5を満足するこ とを特徴とするプロピレン系共重合体。

【請求項2】 示差走査型熱量計を用いた測定により観 測される融点が存在しないか又は該融点が50~165 ℃の範囲にある請求項1記載のプロピレン系共重合体。

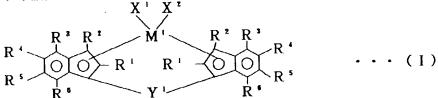
【請求項3】 請求項1記載のプロピレン系共重合体に 炭素数2~20のαーオレフィン、環状オレフィン又は スチレン系単量体をグラフト重合してなり、沸騰キシレ 20 ン不溶部が1%以下であると共にゲルを実質的に含有せ ず、上記プロピレン系共重合体の含有量が0.01~80 重量%であるプロピレン系グラフト共重合体。

【請求項4】 (A)シクロペンタジエニル基を有する 周期律表第4族の遷移金属化合物の中から選ばれた少な くとも一種と、(B)(B-1)アルミニウムオキシ化 合物、(B-2)上記遷移金属化合物と反応してカチオ ンに変換しうるイオン性化合物及び(B-3)粘土,粘 土鉱物又はイオン交換性層状化合物の中から選ばれた少*

*なくとも一種を含有してなる重合触媒の存在下、プロピ レンとジオレフィンとを共重合、又はプロピレンとジオ レフィンと、環状オレフィン及びスチレン系単量体の少 なくとも一種とを共重合させて請求項1記載のプロピレ ン系共重合体を製造することを特徴とするプロピレン系 共重合体の製造方法。

【請求項5】 (A)シクロペンタジエニル基を有する 周期律表第4族の遷移金属化合物の中から選ばれた少な くとも一種と、(B) (B-1) アルミニウムオキシ化 $\mathbf{F}(\mathbf{d})$ デカリン溶媒中で測定した極限粘度〔n〕(デ $\mathbf{10}$ 合物、($\mathbf{B}-\mathbf{2}$)上記遷移金属化合物と反応してカチオ ンに変換しうるイオン性化合物及び(B-3)粘土,粘 土鉱物又はイオン交換性層状化合物の中から選ばれた少 なくとも一種を含有してなる第1の重合触媒の存在下、 プロピレンとジオレフィンとを共重合、又はプロピレン とジオレフィンと、プロピレン以外の炭素数2~20の αーオレフィン、環状オレフィン及びスチレン系単量体 の少なくとも一種とを共重合させて請求項1記載のプロ ピレン系共重合体を形成させたのち、上記第1の重合触 媒の存在下、又はチタン、マグネシウム及び電子供与性 化合物を必須成分として含む固体触媒成分、有機アルミ ニウム化合物並びに第三成分としての電子供与性化合物 からなる第2の重合触媒の存在下、該共重合体にさらに 炭素数2~20のαーオレフィン、環状オレフィン又は スチレン系単量体をグラフト重合させ請求項2記載のプ ロピレン系グラフト共重合体を製造することを特徴とす るプロピレン系グラフト共重合体の製造方法。

【請求項6】 (A)成分の遷移金属化合物が、(A-1) 一般式(I) 【化1】



〔式中、 $R^1 \sim R^6$ は、それぞれ独立に水素原子,ハロ ゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基又は炭素数1~ 20のハロゲン含有炭化水素基を示し、R3 とR4 , R 4 とR⁵ 及びR⁵ とR⁶ のうちの少なくとも一組はたが いに結合して環を形成してもよく、X1 及びX2 はそれ 40 ぞれ独立に水素原子,ハロゲン原子又は炭素数1~20 の炭化水素基を示し、Y1 は二つの配位子を結合する二 価の架橋基であって、炭素数1~20の炭化水素基、炭 素数1~20のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、※

※ゲルマニウム含有基、スズ含有基、-〇-、-C〇-、 -S-, $-SO_2-$, -Se-, -NR'-, -PR'- 、-P(O)R'-、-BR'-又は-A1R'-を 示し、R'は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20 の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素 基を示す。M1 はチタン、ジルコニウム又はハフニウム を示す。〕で表される遷移金属化合物、(A-2)一般 式(II)

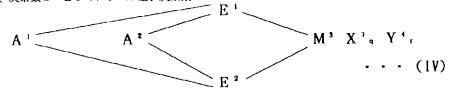
【化2】

〔式中、R7 ~R13, R15, R16, X3 及びX1 は、そ 10*て、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20のハ れぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20 の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素 基、珪素含有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有 基又はリン含有基を示し、R7 とR8 はたがいに結合し て環を形成してもよい。R14, R17は、それぞれ独立に ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1 ~20のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、酸素含 有基、イオウ含有基、窒素含有基またはリン含有基を示 す。Y² は二つの配位子を結合する二価の架橋基であっ*

ロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲルマニウム含有 基、スズ含有基、-O-、-CO-、-S-、-SO2 $-\$ $-Se-\$ $-NR'-\$ $-PR'-\$ -P(O)R'-、-BR'-又は-A1R'-を示し、R'は水 素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基、 炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基を示す。M² はチタン、ジルコニウム又はハフニウムを示す。〕で表 される遷移金属化合物、(A-3)一般式(III) 【化3】

〔式中、R18は同一又は異なって水素原子、炭素数1~ 20のアルキル基、炭素数3~20のシクロアルキル 基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数6~20の アリール基、炭素数7~20のアルキルアリール基又は 炭素数7~20のアリールアルキル基を示し、隣接する 二つのR18は5~8個の炭素原子からなる環を形成して もよく、R18は珪素原子又はゲルマニウム原子を含有し は同一又は異なって、炭素数1~20のアルキル基、炭 素数3~20のシクロアルキル基、炭素数2~20のア ルケニル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数7~※

※20のアルキルアリール基又は炭素数7~20のアリー ルアルキル基であり任意に異原子を含んでいてもよく、 二つのR19は8原子までからなる環状基を形成してもよ い。但し、少なくとも4個の炭素原子が二つのR19に含 まれる。) を示し、M3 はチタン、ジルコニウム又はハ フニウムを示す。X5 及びX6 は同一又は異なって、ハ ロゲン原子、-OH、-SH、-R²⁰、-OR²⁰、-S てもよい。Y³ は>SiR¹⁹2 又は>GeR¹⁹2 (R¹⁹ 40 R²⁰、-NR²⁰2 又は-PR²⁰2 (R²⁰はR¹⁸と同じも のを示す。)を示す。]並びに(A-4)一般式(IV) 【化4】



〔式中、M³ はチタン、ジルコニウム又はハフニウムを★50★示し、E¹ 及びE² はそれぞれ置換シクロペンタジエニ

ル基、インデニル基、置換インデニル基、ヘテロシクロ ペンタジエニル基、置換ヘテロシクロペンタジエニル 基, アミド基, ホスフィド基, 炭化水素基及び珪素含有 基の中から選ばれた配位子であって、A1 及びA2 を介 して架橋構造を形成しており、またそれらはたがいに同 一でも異なっていてもよく、X7 はσ結合性の配位子を 示し、X7 が複数ある場合、複数のX7 は同じでも異な っていてもよく、他の X^7 , E^1 , E^2 又は Y^4 と架橋 していてもよい。Y4 はルイス塩基を示し、Y4 が複数 ある場合、複数のY⁴ は同じでも異なっていてもよく、 他の Y^4 , E^1 , E^2 又は X^7 と架橋していてもよく、 A1 及びA2 は二つの配位子を結合する二個の架橋基で あって、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20 のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲルマニウム 含有基、スズ含有基、一〇一、一C〇一、一S一、一S $O_2 - C - S_e - C - NR' - C - PR' - C - P$ (O) R' -、-BR' -又は-A1R' -を示し、 R' は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化 水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基を示 し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい。 9 20 は1~5の整数で〔(M³の原子価)-2〕を示し、r は0~3の整数を示す。〕で表される遷移金属化合物か ら選ばれた少なくとも一種である請求項4又は5に記載 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はプロビレン系重合体 及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、溶融体の流 動の活性化エネルギーを任意に制御することができ、高 速成形が可能で加工コストが低い上、透明性及び均一性 30 を有するプロビレン系共重合体やプロピレン系グラフト 共重合体、及びこれらの共重合体を効率よく製造する方 法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、ポリプロピレンは、(1) 剛性などの機械的強度が高く、かつ物性バランスに優れる、

- (2)化学的に安定で、耐候性に優れ、化学薬品などに 侵されにくい、(3)融点が高く、耐熱性に優れる、
- (4)軽量で安価である、などの特徴を有するととも に、溶融成形性に優れ、射出成形、キャスト成形などの 40 溶融成形法を適用しうることから、多くの分野において 広範に用いられている。

【0003】また、新しい特性の付与(特に溶融張力)により、ポリプロピレン本来の特性を充分に活かし、より幅広い用途への展開に向けて樹脂設計がなされている。例えば、特開平5-185490号公報、同5-194659号公報、同5-194778号公報、同5-194793号公報、同5-202143号公報、同5-202137号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、同5-202237号公報、

6

同5-202238号公報、同5-202248号公報、同5-209062号公報、同5-212771号公報、同5-212771号公報、同5-214178号公報、同5-21214178号公報、同5-222121号公報、同5-222121号公報、同5-222122号公報、同5-222251号公報、同5-228995号公報、同5-237930号公報及び同5-239232号公報においては、予備重合機媒及び予備重合法を組み合わせることにより、プロビレン系重合体及びこの重合体を含む樹脂組成物に対して、よく改善された溶融張力を付与する技術が開示されている。

【0004】しかしながら、これらの公報で開示されている技術においては、本重合にかかるまでの予備重合操作が少なくとも3段階にわたり、操作が煩雑である上、一般に反応性に乏しく、かつ反応中に環化や架橋反応のおそれのある鎖状非共役ジエンをそのまま用いているなどの問題がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 事情のもとで、溶融体の流動の活性化エネルギーを任意 に制御することができ、高速成形が可能で、加工コスト が低い上、良好な熱安定性、透明性及び均一性を有する プロピレン系共重合体、さらにブロックポリプロピレ ン、異種ポリオレフィン間の相溶性に優れるプロピレン 系共重合体であり、同時にこのものを効率よく製造する 方法を提供することを目的としてなされたものである。 【0006】本発明者らは、前記目的を達成するために 鋭意研究を重ねた結果、プロピレンに由来する末端ビニ ル単位とジオレフィンに由来する炭素-炭素二重結合単 位とからなるものであって、重量平均分子量、ジオレフ ィンに由来する単位含有量、プロピレンを除くオレフィ ンに由来する単位の含有量を一定範囲に制御し、かつ共 重合体中に観測されるビニル基と炭素-炭素二重結合の 総和と極限粘度との積が特定の関係にあるプロピレン系 共重合体及びこの共重合体にオレフィン類をグラフト重 合してなるプロピレン系グラフト共重合体が、前記の好 ましい性質を有すること、そしてこれらは特定の重合触 媒を用いることにより、効率よく製造しうることを見出 した。本発明は、かかる知見に基づいて完成したもので

【0007】すなわち、本発明は、少なくともプロピレンに由来する末端ビニル基とジオレフィン由来の炭素一炭素二重結合を含む重合体であって、次の(a)~(d)

- (a) 重量平均分子量が1500~500000、
- (b) ジオレフィンに由来する単位の含有量が0モル%を超え20モル%以下、(c) プロピレン以外の炭素数2~20のαーオレフィン、環状オレフィン及びスチレン系単量体に由来する単位の含有量が0~50モル%以50下(d) デカリン溶媒中で測定した極限粘度〔n〕(デ

シリットル/g)とプロピレンに由来する末端ビニル基とジオレフィン由来の炭素 炭素二重結合の含有量の和〔C〕との積〔n〕・〔C〕が0.01~5を満足することを特徴とするプロピレン系共重合体(1)、及びこのプロピレン系共重合体に炭素数2~20のαーオレフィン、環状オレフィン又はスチレン系単量体をグラフト重合してなり、沸騰キシレン不溶部が1%以下であると共にゲルを実質的に含有せず、上記プロピレン系共重合体の含有量が0.01~80重量%であるプロピレン系グラフト共重合体(II)を提供するものである。

【0008】また、本発明は、(A)シクロペンタジエ ニル基を有する周期律表第4族の遷移金属化合物の中か ら選ばれた少なくとも一種と、(B) (B-1)アルミ ニウムオキシ化合物、(B-2)上記遷移金属化合物と 反応してカチオンに変換しうるイオン性化合物及び(B -3)粘土、粘土鉱物又はイオン交換性層状化合物の中 から選ばれた少なくとも一種を含有してなる重合触媒の 存在下、プロピレンとジオレフィンとを共重合、又はプ ロピレンとジオレフィンと、プロピレン以外の炭素数2 ~20のα-オレフィン、環状オレフィン及びスチレン 20 系単量体の少なくとも一種とを共重合させて前記プロピ レン系共重合体(I)を製造する方法、及び(A)シク ロペンタジエニル基を有する周期律表第4族の遷移金属 化合物の中から選ばれた少なくとも一種と、(B)(B -1)アルミニウムオキシ化合物、(B-2)上記遷移 金属化合物と反応してカチオンに変換しうるイオン性化 合物及び(B-3)粘土、粘土鉱物又はイオン交換性層 状化合物粘土鉱物の中から選ばれた少なくとも一種を含 有してなる第1の重合触媒の存在下、プロピレンとジオ レフィンとを共重合させて上記プロピレン系共重合体 (I)を形成させたのち、上記第1の重合触媒の存在 下、又はチタン,マグネシウム及び電子供与性化合物か らなる固体触媒成分、有機アルミニウム化合物並びに第 三成分としての電子供与性化合物からなる第2の重合触 媒の存在下、該共重合体にさらに炭素数2~20のα-オレフィン、環状オレフィン又はスチレン系単量体をグ ラフト重合させて上記プロピレン系グラフト共重合体 (11) を製造する方法を提供するものである。

【発明の実施の形態】本発明のプロピレン系共重合体 *40

[0009]

8

*(I)及びプロピレン系グラフト共重合体(II)は、原料モノマーとしてプロピレン及びジオレフィン類を必須とし、さらに、プロピレン以外の炭素数2~20のαーオレフィン、環状オレフィン及びスチレン系単量体が用いられる。該ジオレフィン類としては、αーオレフィン残基、スチレン残基及び環状オレフィン残基の中から選ばれた少なくとも2個の同種又は異種の残基から形成された化合物及び環状ジエン化合物の中から選ばれた多官能性単量体が好ましく用いられる。このような多官能性10単量体としては、例えば直鎖又は分岐の非環式ジエン化合物、単環脂環式ジエン化合物、多環脂環式ジエン化合物、シクロアルケニル置換アルケン類、芳香族環を有するジエン化合物、一分子中にαーオレフィン残基とスチレン残基を有するジエン化合物などが挙げられる。

【0010】該直鎖又は分岐の非環式ジエン化合物としては、例えば1,4-ペンタジエン、1,5-ヘキサジエン、1,6-ヘプタジエン、1,7-オクタジエン、1,9-デカジエン、1,11-ドデカジエン、2-メチル-1,4-ペンタジエン、2-メチル-1,5-ヘキサジエン、3-エチル-1,7-オクタジエンなどが挙げられ、単環脂環式ジエン化合物としては、例えば1,3-シクロペンタジエン、1,4-シクロヘキサジエン、1,5-シクロオクタジエン、1,5-シクロドデカジエン、1,2-ジビニルシクロヘキサン、1,3-ジビニルシクロへキサンなどが挙げられる。

【0011】また、多環脂環式ジエン化合物としては、例えばジシクロペンタジエン、ノルボルナジエン、テトラヒドロインデン、5-メチルー2,5-ノルボルナジエン、さらにはアルケニ 30 ル、アルキリデン、シクロアルケニル及びシクロアルキリデンのノルボルネンであって、例えば5-メチリデンー2-ノルボルネン、5-エチリデン-2-ノルボルネン、5-イソプロピリデン-2-ノルボルネン、5-イソプロピリデン-2-ノルボルネン、5-ビニルノルボルネン、5-(3-シクロペンテニル)-2-ノルボルネン、及び式

【0012】 【化5】

のプロピレン系共重合体 *40 (CH_z)_n (n=0~4)

【0013】で示される化合物などが挙げられる。シク ※クロヘキセン、ビニルシクロオクテン、アリルシクロデロアルケニル置換アルケン類としては、例えばアリルシ※50 セン、ビニルシクロドデセンなどが挙げられ、芳香族環

を有するジエン化合物としては、例えばp ジビニルベ ンゼン、m ジビニルベンゼン、o ジビニルベンゼ ン、ジー (pービニルフェニル) メタン、1,3ービス (p-ビニルフェニル) プロパン、1,5-ビス (p-

ビニルフェニル) ペンタンなどが挙げられる。 【0014】一分子中にαーオレフィン残基とスチレン **残基とを有するジエン化合物としては、例えばp-(2** ープロペニル)スチレン、m-(2-プロペニル)スチ レン、pー(3ープテニル)スチレン、mー(3ープテ ニル)スチレン、o-(3-ブテニル)スチレン、p- 10 ブロモスチレン、m-ブロモスチレン、o-ブロモスチ (4-ペンテニル) スチレン、m-(4-ペンテニル) スチレン、o-(4-ペンテニル) スチレン、p-(7 ーオクテニル) スチレン、pー (1ーメチルー3ーブテ ニル) スチレン、p--(2-メチル-3-ブテニル) ス チレン、m- (2-メチルー3-ブテニル) スチレン、 o-(2-メチルー3-ブテニル)スチレン、p-(3 メチルー3ーブテニル) スチレン、p-(2-エチル -4-ペンテニル) スチレン、p-(3-ブテニル) α-メチルスチレン、m-(3-ブテニル)-α-メチ ルスチレン、oー(3ープテニル)ーαーメチルスチレ 20 ン、4ービニルー4' -- (3ープテニル) ピフェニル、 4ービニルー3' - (3ープテニル) ビフェニル、4-ビニルー4'-(4ーペンテニル) ビフェニル、4ービ ニルー2'-(4ーペンテニル) ビフェニル、4ービニ ルー4'-(2-メチルー3ーブテニル) ビフェニルな どが挙げられる。これらのジオレフィン類は、一種用い てもよいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。 【0015】プロピレンを除く炭素数2~20のα-オ レフィンとしては、例えばエチレン、1 - ブテン、1 -ペンテン、4ーメチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、 1ーオクテン、1ーデセン、1ードデセン、1ーテトラ デセン、1 -ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エ イコセンなどが挙げられる。環状オレフィンとしては、 炭素数3~20のものが好ましく、具体的にはシクロペ ンテン、シクロヘキセン、ノルボルネン、1ーメチルノ ルボルネン、5-メチルノルボルネン、7-メチルノル ボルネン、5,6-ジメチルノルボルネン、5,5,6

*ン、5 ベンジルノルボルネンなどが挙げられる。スチ レン系単量体としては、スチレン及びその誘導体(炭 素、ハロゲン、ケイ素などを含む置換基を有するも

1.0

の)、具体的にはスチレン、pーメチルスチレン、o= メチルスチレン、m-メチルスチレン、2,4-ジメチ ルスチレン、2,5ージメチルスチレン、3,4ージメ チルスチレン、3,5ージメチルスチレン、pーtーブ チルスチレンなどのアルキルスチレン、p - クロロスチ レン、mークロロスチレン、oークロロスチレン、pー レン、pーフルオロスチレン、mーフルオロスチレン、 o-フルオロスチレン、o-メチル--p-フルオロスチ レンなどのハロゲン化スチレン、4-ビニルビフェニ ル、3ービニルビフェニル、2ービニルビフェニルなど のビニルビフェニル類などが挙げられる。本発明におい ては、これらのモノマーは、一種を単独で用いてもよい し、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0016】本発明のプロピレン系共重合体(I)を製 造するには、重合触媒として、(A)シクロペンタジエ ニル基を有する周期律表第4族の遷移金属化合物の中か ら選ばれた少なくとも一種と、(B)(B-1)アルミ ニウムオキシ化合物、(B-2)上記遷移金属化合物と 反応してカチオンに変換しうるイオン性化合物及び(B --3) 粘土, 粘土鉱物又はイオン交換性層状化合物の中 から選ばれた少なくとも一種を含有してなる重合触媒を 用いることが好ましい。また、プロピレン系グラフト共 重合体 (II) の製造には、重合触媒として、上記と同様 の重合触媒又はチタン,マグネシウム及び電子供与性化 合物を必須成分として含む固体触媒成分、有機アルミニ ウム化合物並びに第三成分としての電子供与性化合物か らなる重合触媒を用いることが好ましい。

【0017】上記(A)成分のシクロペンタジエニル基 を有する周期律表第4族の遷移金属化合物としては、例 えば下記の (A-1) 成分、(A-2) 成分、(A-3) 成分及び (A-4) 成分から選ばれた一種を挙げる ことができる。

(A-1)成分: (A-1)成分は、一般式(I) [0018] 【化6】

【0019】〔式中、R1~R6 は、それぞれ独立に水 素原子,ハロゲン原子,炭素数1~20の炭化水素基又 は炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基を示し、R ³ とR⁴ , R⁴ とR⁵ 及びR⁵ とR⁶ のうちの少なくと も一組はたがいに結合して環を形成してもよく、 $f X^1$ 及st S50 珪素含有基、ゲルマニウム含有基、スズ含有基、f - O

ートリメチルノルボルネン、5ーエチルノルボルネン、

※びX² はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子又は炭 素数1~20の炭化水素基を示し、Y1 は二つの配位子 を結合する二価の架橋基であって、炭素数1~20の炭 化水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基、

CO , S , SO_2 , Se , N、PR'、P(O)R'、BR'又 は-A1R'-を示し、R'は水素原子、ハロゲン原 子、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20のハ ロゲン含有炭化水素基を示す。M「はチタン、ジルコニ ウム又はハフニウムを示す。〕で表される遷移金属化合 物である。

【0020】一般式(I)において、 R^3 と R^4 , R^4 とR⁵ 及びR⁵ とR⁶ のうちの少なくとも一組が環を形 成した遷移金属化合物は、BASF型錯体として知られ 10 ている化合物である。前記一般式(I)において、 R^1 ~R6 のうちのハロゲン原子としては、塩素,臭素,フ ッ素、ヨウ素原子が挙げられる。炭素数1~20の炭化 水素基としては、例えばメチル基,エチル基,nープロ ピル基, イソプロピル基, n-ブチル基, イソブチル 基,tert-ブチル基,n-ヘキシル基,n-デシル 基などのアルキル基、フェニル基,1ーナフチル基,2 -ナフチル基などのアリール基、ベンジル基などのアラ ルキル基などが挙げられ、また炭素数1~20のハロゲ ン含有炭化水素基としては、上記炭化水素基の水素原子 20 の1個以上が適当なハロゲン原子で置換された基が挙げ られる。このR1 ~R6 は、たがいに同一であっても異 なっていてもよく、また、隣接する基、すなわちR³と R4 , R4 とR5 及びR5 とR6 のうちの少なくとも一 組はたがいに結合して環を形成していることが必要であ る。このような環を形成したインデニル基としては、例 えば4,5-ベンゾインデニル基,α-アセナフトイン デニル基及びその炭素数1~10のアルキル置換体など を挙げることができる。

【0021】また、X1 及びX2 のうちハロゲン原子と 30 しては、塩素、臭素、フッ素、ヨウ素原子が挙げられ、 炭素数1~20の炭化水素基としては、例えばメチル 基, エチル基, プロピル基, イソプロピル基, n‐ブチ ル基、tert-ブチル基、n-ヘキシル基などのアル キル基、フェニル基などのアリール基、ベンジル基など のアラルキル基などが挙げられる。X1 及びX2 はたが いに同一であっても異なってもよい。一方、Y1 は二つ の配位子を結合する二価の基であって、そのうちの炭素 数 $1\sim\!20$ の二価の炭化水素基としては、例えばメチレ ン基;ジメチルメチレン基;1,2-エチレン基;ジメ 40 チルー1,2-エチレン基;1,4-テトラメチレン 基;1,2-シクロプロピレン基などのアルキレン基、 ジフェニルメチレン基などのアリールアルキレン基など が挙げられ、炭素数1~20の二値のハロゲン含有炭化 水素基としては、例えばクロロエチレン基、クロロメチ レン基などが挙げられる。また、二価の珪素含有基とし ては、例えばメチルシリレン基,ジメチルシリレン基, ジエチルシリレン基、ジフェニルシリレン基、メチルフ ェニルシリレン基などが挙げられる。さらに、ゲルマニ ウム含有基,スズ含有基としては、上記珪素含有基にお 50 ル) – ジルコニウムジクロリド,フェニルメチルシラン

いて、珪素をゲルマニウム、スズに変換した基を挙げる ことができる。なお、Y1 で結合されている二つの配位 子は通常同一であるが、場合により異なっていてもよ

【0022】この(A-1)成分の一般式(1)で表さ れる遷移金属化合物としては、例えば、特開平6-18 4179号公報,特開平6-345809号公報などに 記載されている化合物を挙げることができる。具体例と しては、rac-ジメチルシランジイルーピス-1-(2-メチル-4, 5-ベンゾインデニル) ージルコニ ウムジクロリド,rac-フェニルメチルシランジイル ービスー1-(2-メチルー4,5-ベンゾインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド, rac-エタンジイル ービス-1-(2-メチル-4,5-ベンゾインデニ ル) ージルコニウムジクロリド, rac-ブタンジイル ービスー1ー(2-メチルー4,5-ベンゾインデニ ル) ージルコニウムジクロリド, racージメチルシラ ンジイルービス-1-(4,5-ベンゾインデニル)= ジルコニウムジクロリド,rac-ジメチルシランジイ ルービス-1-(2-メチル-α-メチル-α-アセナ フトインデニル) ージルコニウムジクロリド,rac‐ フェニルメチルシランジイルービス-1-(2-メチル -α-アセナフトインデニル) -ジルコニウムジクロリ ドなどのベンゾインデニル型又はアセナフトインデニル 型化合物、及びこれらの化合物におけるジルコニウムを チタン又はハフニウムに置換したものなどを挙げること ができる。

【0023】さらに、(A-1)成分は、前記一般式 (I) において、R³ とR⁴ , R⁴ とR⁵ 及びR⁵ とR 6 のいずれの組も環を形成していないインデニル骨格を 有する遷移金属化合物又はそれに対応する4,5,6, 7-テトラヒドロインデニル骨格を有する遷移金属化合 物である。この遷移金属化合物は、ヘキスト型錯体とし て知られている化合物である。この(A-1)成分の遷 移金属化合物としては、例えば、特開平4-26830 8号公報,同5-306304号公報,同6-1005 79号公報,同6-157661号公報,同7-149 815号公報,同7-188318号公報,同7-25 8321号公報などに記載されている化合物を挙げるこ とができる。具体例としては、ジメチルシランジイルー ビスー1ー(2-メチルー4-フェニルインデニル)-ジルコニウムジクロリド, ジメチルシランジイルービス -1-[2-メチルー4-(1-ナフチル)インデニ ル】ージルコニウムジクロリド,ジメチルシランジイル ービス-1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) ージルコニウムジクロリド,ジメチルシランジイルービ スー1-〔2-エチル-4-(1-ナフチル)インデニ ル〕ジルコニウムジクロリド、フェニルメチルシランジ イルービスー1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ジイル ビス 1 〔2 メチル 4 〔1 ナフチ ル) インデニル〕 ジルコニウムジクロリド,フェニル メチルシランジイルービスー1-(2-エチルー4-フ ェニルインデニル) ージルコニウムジクロリド,フェニ ルメチルシランジイルービスー1ー〔2ーエチルー4ー (1-ナフチル) インデニル] ージルコニウムジクロリ ドなどのアリール置換体、racージメチルシリレン= ビス-1-(2-メチル-4-エチルインデニル)・ジ ルコニウムジクロリド、racージメチルシリレンービ ージルコニウムジクロリド, racージメチルシリレン ービス-1-(2-メチル-4-第三ブチルインデニ ル) - ジルコニウムジクロリド, rac-フェニルメチ ルシリレンービスー1ー(2-メチルー4-イソプロピ ルインデニル) ージルコニウムジクロリド, rac=ジ メチルシリレンービスー1ー(2ーエチルー4-メチル インデニル) ージルコニウムジクロリド,racージメ チルシリレンーピスー1ー(2,4ージメチルインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド, rac-ジメチルシリ レンービス-1-(2-メチル-4-エチルインデニ ル)ージルコニウムジメチルなどの2,4一位置換体、 rac-ジメチルシリレンービス-1-(4,7-ジメ チルインデニル) ージルコニウムジクロリド, rac-1,2-エタンジイルービス-1-(2-メチル-4. **7-ジメチルインデニル) ージルコニウムジクロリド,** rac-ジメチルシリレンービス-1-(3,4,7-トリメチルインデニル) ージルコニウムジクロリド, r ac-1, 2-エタンジイルービス-1-(4, 7-ジ メチルインデニル) ージルコニウムジクロリド, rac -1,2-ブタンジイルービス-1-(4,7-ジメチ ルインデニル) ージルコニウムジクロリドなどの4,7 -位, 2, 4, 7-位又は3, 4, 7-位置換体, ジメ チルシランジイルーピスー1 - (2-メチルー4,6-ジイソプロピルインデニル) ージルコニウムジクロリ

13

*チル 4,6 ジイソプロピルインデニル) ジルコニ ウムジクロリド、 rac - ジメチルシランジイル - ビス -1-(2-メチル-4,6-ジイソプロピルインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド, rac-1, 2-エタ ンジイルービスー1ー(2ーメチルー4,6ージイソプ ロピルインデニル) ージルコニウムジクロリド, rac ージフェニルシランジイルーピス-1-(2-メチルー 4,6-ジイソプロピルインデニル)ージルコニウムジ クロリド, rac-フェニルメチルシランジイルービス スー1-(2-メチル-4-イソプロピルインデニル) 10 -1-(2-メチル-4,6-ジイソプロピルインデニ ル) ージルコニウムジクロリド、racージメチルシラ ンジイルービスー1ー(2,4,6ートリメチルインデ ニル) ージルコニウムジクロリドなどの2, 4,6一位 置換体、rac-ジメチルシランジイルーピス-1-(2, 5, 6-トリメチルインデニル) ージルコニウム ジクロリドなどの2,5,6-位置換体、rac-ジメ チルシリレンーピスー(2-メチルー4,5,6,7 テトラヒドロー1ーインデニル) ージルコニウムジクロ リド、rac-エチレン-ピスー(2-メチル-4, 20 5, 6, 7ーテトラヒドロー1ーインデニル) ージルコ ニウムジクロリド,rac-ジメチルシリレンービスー (2-x+v-4, 5, 6, 7-r+r-1-1-1ンデニル) ージルコニウムジメチル, racーエチレン ービス(2-メチルー4,5,6,7-テトラヒドロー 1-インデニル) ージルコニウムジメチル, rac-エ チレンービスー(4,7ージメチルー4,5,6,7ー テトラヒドロー1ーインデニル) ージルコニウムジクロ リドなどの4,5,6,7ーテトラヒドロインデニル化 合物など、及びこれらの化合物におけるジルコニウムを 30 チタン又はハフニウムに置換したものなどを挙げること ができる。 (A-2)成分: (A-2)成分は一般式(II)

ド、フェニルメチルシランジイルーピスー1-(2-メ*
$$R^{11}$$
 R^{13}
 R^{15}
 R^{14}
 R^{13}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}
 R^{1}

[0024]

【化7】

【0025】〔式中、R⁷~R¹³, R¹⁵, R¹⁶, X³及 びX4 は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭 素数1~20の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン 含有炭化水素基、珪素含有基、酸素含有基、イオウ含有 基、窒素含有基又はリン含有基を示し、R7 とR8 はた がいに結合して環を形成してもよい。 R^{14} , R^{17} は、 $4<math>\times 50$ $1\sim 20$ のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲル

※れぞれ独立にハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素 基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基、珪素含 有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基またはリ ン含有基を示す。Y² は二つの配位子を結合する二価の 架橋基であって、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数 マニウム含有基、スズ含有基、 〇 、 CO 、 S -P (O) R'-、-BR'-Xは-A1R'-を示 し、R'は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の 炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基 を示す。M² はチタン, ジルコニウム又はハフニウムを

示す。〕で表される遷移金属化合物である。 【0026】この遷移金属化合物は、単架橋型錯体であ る。前記一般式 (II) において、 $R^7 \sim R^{13}$, R^{15} , R16, X3 及びX4 のうちのハロゲン原子としては、塩 素, 臭素, フッ素, ヨウ素原子が挙げられる。炭素数1 ~20の炭化水素基としては、例えばメチル基, エチル 基,n-プロピル基,イソプロピル基,n-ブチル基, イソブチル基,tert‐ブチル基,n‐ヘキシル基, n-デシル基などのアルキル基、フェニル基、1-ナフ チル基,2ーナフチル基などのアリール基、ベンジル基 などのアラルキル基などが挙げられ、また炭素数1~2 0のハロゲン含有炭化水素基としては、トリフルオロメ チルなどの上記炭化水素基の水素原子の1個以上が適当 なハロゲン原子で置換された基が挙げられる。珪素含有 20 基としては、トリメチルシリル基、ジメチル(t-ブチ ル)シリル基などが挙げられ、酸素含有基としては、メ トキシ基,エトキシ基などが挙げられ、イオウ含有基と しては、メチルチオ基,エチルチオ基などが挙げられ、 窒素含有基としては、ジメチルアミノ基などが挙げら れ、リン含有基としてはメチルホスフィン基、フェニル ホスフィン基などが挙げられる。また、R7 とR8 はた がいに結合してフルオレンなどの環を形成してもよい。 R14、R17の具体例としては、上記R7~R13等におい て挙げたものから水素原子を除く基が挙げられる。 R7, R8 としては、水素原子及び炭素数6以下のアル キル基が好ましく、水素原子、メチル基、エチル基、イ ソプロピル基、シクロヘキシル基がより好ましく、水素 原子がさらに好ましい。また、 ${
m R^9}$, ${
m R^{12}}$, ${
m R^{14}}$ 及び R17としては、炭素数6以下のアルキル基が好ましく、 メチル基、エチル基、イソプロピル基、シクロヘキシル 基がより好ましく、イソプロピル基がさらに好ましい。 R¹⁰, R¹¹, R¹³, R¹⁵ 及びR¹⁶としては水素原子が 好ましい。X3 , X4 としては、ハロゲン原子,水素, 炭素数1~3のアルキル基が好ましい。

16

【0027】Y² の具体例としては、メチレン、エチレ ン、エチリデン、イソプロピリデン、シクロヘキシリデ ン、1,2-シクロヘキシレン、ジメチルシリレン、テ トラメチルジシリレン、ジメチルゲルミレン、メチルボ リリデン (CH3 -B=)、メチルアルミリデン (CH 3 -Al=)、フェニルホスフィリデン(Ph-P =)、フェニルホスホリデン(PhPO=)、1,2-フェニレン、ビニレン (-CH=CH-)、ビニリデン (CH₂ =C=)、メチルイミド、酸素(-O-)、硫 10 黄 (-S-) などがあり、これらの中でも、メチレン、 エチレン、エチリデン、イソプロピリデンが、合成の容 易さ、収率の点で好ましい。M2 はチタン,ジルコニウ ム又はハフニウムを示すが、特にハフニウムが好適であ

【0028】前記一般式 (II) で表される遷移金属化合 物の具体例としては、1,2-エタンジイル(1-(4, 7ージイソプロピルインデニル))(2-(4. 7-ジイソプロピルインデニル) ハフニウムジクロリ ド、1、2-エタンジイル(9-フルオレニル)(2-(4, 7-ジイソプロピルインデニル) ハフニウムジク ロリド、イソプロピリデン(1-(4,7-ジイソプロ ビルインデニル))(2-(4,7-ジイソプロピルイ ンデニル) ハフニウムジクロリド、1,2-エタンジイ ル(1-(4,7-ジメチルインデニル))(2-(4, 7-ジイソプロピルインデニル) ハフニウムジク ロリド、1,2-エタンジイル(9-フルオレニル) (2-(4,7-ジメチルインデニル))ハフニウムジ クロリド、イソプロピリデン(1-(4,7ージメチル インデニル))(2-(4,7-ジイソプロピルインデ 30 ニル) ハフニウムジクロリドなど、及びこれらの化合物 におけるハフニウムをジルコニウム又はチタンに置換し たものを挙げることができるが、これらに限定されるも のではない。なお、前記一般式(II)で表される遷移金 属化合物は、例えば本出願人が先に出願した特願平09 -296612号明細書に記載された方法により製造す ることができる。

(A-3)成分: (A-3)成分は、一般式(III) [0029] 【化8】

【0030】〔式中、R¹⁸は同一又は異なっていてもよ く、それぞれ水素原子、炭素数1~20のアルキル基、 炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数2~20の アルケニル基、炭素数6~20のアリール基、炭素数7 ~20のアルキルアリール基又は炭素数7~20のアリ ールアルキル基を示し、隣接する二つのR18は5~8個 の炭素原子からなる環を形成してもよく、R18は珪素原 20 ジクロリド,ジエチルシランジイルビス (フルオレニ 子又はゲルマニウム原子を含有してもよい。Y3 は>S i R¹⁹2 又は>G e R¹⁹2 (R¹⁹は同一又は異なって、 炭素数1~20のアルキル基、炭素数3~20のシクロ アルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数6 ~20のアリール基、炭素数7~20のアルキルアリー ル基又は炭素数7~20のアリールアルキル基であり任 意に異原子を含んでいてもよく、二つのR¹⁹は8原子ま でからなる環状基を形成してもよい。但し、少なくとも 4個の炭素原子が二つのR19に含まれる。)を示し、M ³ はチタン,ジルコニウム又はハフニウムを示す。X⁵ 及びX6 は同一又は異なって、ハロゲン原子、一〇H、 -SH, $-R^{20}$, $-OR^{20}$, $-SR^{20}$, $-NR^{20}$, X-PR²⁰2 (R²⁰はR¹⁸と同じものを示す。)を示 す。〕で表される遷移金属化合物である。

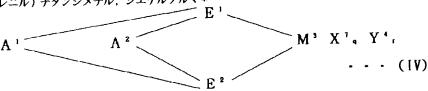
【0031】前記一般式(III) において、好ましいR¹⁸ としては水素原子、炭素数1~10、より好ましくは炭 素数1~3のアルキル基、炭素数3~10、より好まし くは炭素数3~6のシクロアルキル基、炭素数2~1 0、より好ましくは炭素数2~3のアルケニル基、炭素 数8~10のアリール基、炭素数7~10のアルキルア 40 リール基又は炭素7~10のアリールアルキル基であ る。アルキル基は、線状、分岐状、環状のいずれであっ てもよい。好ましいY³ は、>SiR¹º2 又は>GeR 192 において、R19が炭素数1~10、より好ましくは 炭素数4~8のアルキル基であるものであり、特にビス (n-ブチル) シランジイル基が好ましい。M³ はチタ ン、ジルコニウム又はハフニウムを示すが、特にジルコ ニウムが好ましい。X5 , X6 としてはハロゲン原子、 R²⁰がアルキルキ基であるものが好ましく、特に好まし くは塩素原子又はメチル基である。

*【0032】前記一般式(III) で表される遷移金属化合 物の具体例としては、ジメチルシランジイルビス(フル オレニル) チタンジクロリド, ジメチルシランジイルビ ス (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド,ジメチル シランジイルビス (フルオレニル) ハフニウムジクロリ ド,ジエチルシランジイルビス (フルオレニル) チタン ル) ジルコニウムジクロリド,ジエチルシランジイルビ ス (フルオレニル) ハフニウムジクロリド,ジエチルシ ランジイルビス (フルオレニル) チタンジメチル, ジエ チルシランジイルビス (フルオレニル) ジルコニウムジ メチル,ジエチルシランジイルビス (フルオレニル) ハ フニウムジメチル,ジ (n-プロピル) シランジイルビ ス (フルオレニル) チタンジクロリド,ジ(n-プロピ ル) シランジイルビス (フルオレニル) ジルコニウムジ クロリド,ジ (n-プロピル) シランジイルビス (フル 30 オレニル) ハフニウムジクロリド, ジ (n-プロピル) シランジイルビス (フルオレニル) チタンジメチル,ジ (n-プロピル) シランジイルビス (フルオレニル) ジ ルコニウムジメチル,ジ (n-プロピル) シランジイル ビス (フルオレニル) ハフニウムジメチル,ジ(n-ブ チル) シランジイルビス (フルオレニル) チタンジクロ リド,ジ(n-ブチル)シランジイルビス(フルオレニ ル) ジルコニウムジクロリド, ジ (n-ブチル) シラン ジイルビス (フルオレニル) ハフニウムジクロリド,ジ (n-ブチル) シランジイルビス (フルオレニル) チタ ンジメチル,ジ (n-ブチル) シランジイルビス (フル オレニル) ジルコニウムジメチル,ジ(n-ブチル)シ ランジイルビス (フルオレニル) ハフニウムジメチル, メチル (n-ブチル) シランジイルビス (フルオレニ ル) チタンジクロリド,メチル(n-ブチル)シランジ イルビス (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド,メ チル (n-ブチル) シランジイルビス (フルオレニル) ハフニウムジクロリド,メチル(n-ブチル)シランジ イルビス (フルオレニル) チタンジメチル,メチル(n ープチル) シランジイルビス (フルオレニル) ジルコニ *50 ウムジメチル,メチル(n-ブチル)シランジイルビス

20 *ンジイルビス (フルオレニル) ジルコニウムジメチル,

(フルオレニル) ハフニウムジメチル,メチル(n へ キシル)シランジイルビス(フルオレニル)チタンジク ロリド,メチル(n-ヘキシル)シランジイルビス(フ ルオレニル) ジルコニウムジクロリド,メチル(n-ヘ キシル) シランジイルビス (フルオレニル) ハフニウム ジクロリド,メチル(n-オクチル)シランジイルビス (フルオレニル) チタンジクロリド,メチル(n-オク チル) シランジイルビス (フルオレニル) ジルコニウム ジクロリド,メチル(n-オクチル)シランジイルビス マンジイルビス (フルオレニル) チタンジクロリド,ジ エチルゲルマンジイルビス (フルオレニル) ジルコニウ ムジクロリド,ジエチルゲルマンジイルビス (フルオレ ニル) ハフニウムジクロリド, ジエチルゲルマンジイル ビス (フルオレニル) チタンジメチル, ジエチルゲルマ*

ジエチルゲルマンジイルビス (フルオレニル) ハフニウ ムジメチル,ジエチルシランジイルビス(1-メチルフ ルオレニル)チタンジクロリド,ジエチルシランジイル ビス (1-メチルフルオレニル) ジルコニウムジクロリ ド,ジエチルシランジイルビス(1-メチルフルオレニ ル) ハフニウムジクロリド,ジエチルシランジイルビス (1-メチルフルオレニル) チタンジメチル、ジエチル シランジイルビス (1-メチルフルオレニル) ジルコニ (フルオレニル) ハフニウムジクロリド,ジエチルゲル 10 ウムジメチル,ジエチルシランジイルビス(1-メチル フルオレニル) ハフニウムジメチルなどが挙げられる。 (A-4)成分: (A-4)成分は、一般式(IV) [0033] 【化9】



【0034】〔式中、M3 はチタン、ジルコニウム又は ハフニウムを示し、E¹ 及びE² はそれぞれ置換シクロ ペンタジエニル基,インデニル基,置換インデニル基, ヘテロシクロペンタジエニル基、置換ヘテロシクロペン タジエニル基,アミド基,ホスフィド基,炭化水素基及 び珪素含有基の中から選ばれた配位子であって、 A^1 及 びA² を介して架橋構造を形成しており、またそれらは たがいに同一でも異なっていてもよく、X⁷ はσ結合性 の配位子を示し、X7 が複数ある場合、複数のX7 は同 30 じでも異なっていてもよく、他の X^7 , E^1 , E^2 又は Y¹ と架橋していてもよい。Y¹ はルイス塩基を示し、 Y4 が複数ある場合、複数のY4 は同じでも異なってい てもよく、他の Y^4 , E^1 , E^2 又は X^7 と架橋してい てもよく、A1 及びA2 は二つの配位子を結合する二価 の架橋基であって、炭素数1~20の炭化水素基、炭素 数1~20のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲ ルマニウム含有基、スズ含有基、-〇-、-CO-、- $S = \langle -SO_2 - \langle -Se - \langle -NR' - \langle -PR' \rangle \rangle$ - 、- P (O) R' - 、-BR' -又は-A1R' -を 示し、R'は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20 の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素 基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよ い。qは1~5の整数で〔(M3 の原子価)-2〕を示 し、rは0~3の整数を示す。〕で表される遷移金属化 合物(以下、二重架橋型錯体と称することがある。)で ある。

【0035】前記一般式(IV)において、M3 はチタン, ジルコニウム又はハフニウムを示すが、ジルコニウム、 ハフニウムが好適である。 ${
m E}^1$ 及び ${
m E}^2$ は上述のようにst 50 ような架橋基としては、例えば一般式

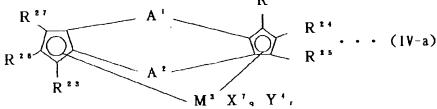
※それぞれ、置換シクロペンタジエニル基,インデニル 基、置換インデニル基、ヘテロシクロペンタジエニル 基,置換へテロシクロペンタジエニル基,アミド基(-N<) , ホスフィド基 (-P<) , 炭化水素基〔>CR -, >C<] 及び珪素含有基〔>SiR-, >Si<) (但し、Rは水素または炭素数1~20の炭化水素基あ るいはヘテロ原子含有基である)の中から選ばれた配位 子を示し、A¹ 及びA² を介して架橋構造を形成してい る。また、E¹ 及びE² はたがいに同一でも異なってい てもよい。このE¹ 及びE² としては、置換シクロペン タジエニル基,インデニル基及び置換インデニル基が好 ましい。

【0036】また、 X^7 で示される σ 結合性配位子の具 体例としては、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水 素基,炭素数1~20のアルコキシ基,炭素数6~20 のアリールオキシ基、炭素数1~20のアミド基、炭素 数1~20の珪素含有基,炭素数1~20のホスフィド 基,炭素数1~20のスルフィド基,炭素数1~20の アシル基などが挙げられる。このX7 が複数ある場合、 複数のX7 は同じでも異なっていてもよく、他のX7 , E^1 , E^2 又は Y^4 と架橋していてもよい。一方、 Y^4 で示されるルイス塩基の具体例としては、アミン類,エ ーテル類、ホスフィン類、チオエーテル類などを挙げる ことができる。このY1 が複数ある場合、複数のY1 は 同じでも異なっていてもよく、他のY⁴ やE¹, E²又 はX7 と架橋していてもよい。次に、A1 及びA2 で示 される架橋基のうち、少なくとも一つは炭素数1以上の 炭化水素基からなる架橋基であることが好ましい。この

21 [0037] 【化10】

【0038】(R21は水素原子又は炭素数1~20の炭 化水素基を示し、複数のR²¹は同一でも異なっていても よく、またたがいに結合して環構造を形成していてもよ られ、その具体例としては、メチレン基、エチレン基、 エチリデン基、プロピリデン基、イソプロピリデン基、 シクロヘキシリデン基、1、2-シクロヘキシレン基、*

る。これらの中で、メチレン基、エチレン基及びイソプ ロピリデン基が好適である。このA1 及びA2 は、たが いに同一でも異なっていてもよい。この一般式(IV)で表 される遷移金属化合物において、E¹ 及びE² が置換シ クロペンタジエニル基、インデニル基又は置換インデニ ル基である場合、A1 及びA2 の架橋基の結合は、 (1, 1')(2, 2') 二重架橋型であってもよく、 (1,2')(2,1')二重架橋型であってもよい。 い。eは $1\sim4$ の整数を示す。)で表されるものが挙げ 10 このような一般式(IV)で表される遷移金属化合物の中で は、一般式(IV-a) [0039] 【化11】 R21



【0040】で表される二重架橋型ビスシクロペンタジ エニル誘導体を配位子とする遷移金属化合物が好まし い。上記一般式(IV-a) において、M³ , A¹ , A² , q及びrは上記と同じである。X7 はσ結合性の配位子 を示し、X7 が複数ある場合、複数のX7 は同じでも異 なっていてもよく、他のX7 又はY4 と架橋していても よい。このX7 の具体例としては、一般式(IV)のX7 の 説明で例示したものと同じものを挙げることができる。 Y4 はルイス塩基を示し、Y4 が複数ある場合、複数の Y4 は同じでも異なっていてもよく、他のY4 又はX7 と架橋していてもよい。このY4 の具体例としては、一 般式(IV)のY⁴ の説明で例示したものと同じものを挙げ ることができる。 $R^{22} \sim R^{27}$ はそれぞれ水素原子,ハロ ゲン原子,炭素数1~20の炭化水素基,炭素数1~2 0のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基又はヘテロ原 子含有基を示すが、その少なくとも一つは水素原子でな いことが必要である。また、R22~R27はたがいに同一 でも異なっていてもよく、隣接する基同士がたがいに結 合して環を形成していてもよい。

【0041】この二重架橋型ビスシクロペンタジエニル 40 誘導体を配位子とする遷移金属化合物は、配位子が (1,1')(2,2')二重架橋型及び(1,2') (2,1')二重架橋型のいずれであってもよい。この 一般式(IV)で表される遷移金属化合物の具体例として は、(1,1'-エチレン)(2,2'-エチレン)-ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 2'-エチレン)(2,1'-エチレン)-ビス(イン デニル) ジルコニウムジクロリド,(1,1'ーメチレ ン) (2, 2'ーメチレン)ービス(インデニル)ジル コニウムジクロリド、(1,2'ーメチレン)(2,※50 ン)ーピス(4ーフェニルインデニル)ジルコニウムジ

※1'-メチレン)-ビス(インデニル)ジルコニウムジ クロリド、(1,1'ーイソプロピリデン)(2,2' ーイソプロピリデン) ービス (インデニル) ジルコニウ ムジクロリド、(1,2'-イソプロピリデン)(2, 1'-イソプロピリデン)ービス (インデニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1、1'ーエチレン)(2、2' ーエチレン) ービス (3ーメチルインデニル) ジルコニ ウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-エチレン) ーピス (3ーメチルインデニル) ジルコニウ ムジクロリド、(1,1'-エチレン)(2,2'-エ チレン) ービス (4、5ーベンゾインデニル) ジルコニ ウムジクロリド,(1,2'-エチレン)(2,1'-エチレン) ービス (4,5ーベンゾインデニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1,1'-エチレン)(2,2' ーエチレン) ービス (4ーイソプロピルインデニル) ジ ルコニウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2, 1'-エチレン)ービス (4ーイソプロピルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'ーエチレン) (2, 2'ーエチレン)ービス(5,6ージメチルイン デニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-エチレ ン) (2, 1'-エチレン) ービス(5,6ージメチル インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-エ チレン)(2,2'-エチレン)ービス(4,7ージイ ソプロピルインデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-エチレン)(2, 1'-エチレン)ービス (4, 7-ジイソプロピルインデニル) ジルコニウムジ **クロリド,(1,1'-エチレン)(2,2'-エチレ** ン) ービス(4-フェニルインデニル)ジルコニウムジ クロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-エチレ

クロリド、(1,1' エチレン)(2,2' エチレ ン) ビス(3 メチル 4 イソプロピルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-エチレン) (2, 1'ーエチレン)ービス(3-メチルー4ーイソ プロピルインデニル)ジルコニウムジクロリド,(1, 1'-エチレン)(2,2'-エチレン)-ビス(5, 6ーベンゾインデニル) ジルコニウムジクロリド、 (1, 2'-エチレン)(2, 1'-エチレン)ービス (5,6-ベンゾインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、(1,1'-エチレン)(2,2'-イソプロピリ 10 デン) ービス (インデニル) ジルコニウムジクロリド, (1,2'-エチレン)(2,1'-イソプロピリデ **ン) ービス (インデニル) ジルコニウムジクロリド**, (1, 1'-イソプロピリデン)(2, 2'-エチレ ン) ービス (インデニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'ーメチレン)(2, 1'ーエチレン)ービス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-メチレン) (2, 2' ーエチレン) ービス (インデニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-エチレン) (2, 2'ーメチレン)ービス (インデニル) ジルコニ 20 ウムジクロリド、(1,1'ーメチレン)(2,2'ー イソプロピリデン) ービス (インデニル) ジルコニウム ジクロリド、(1,2'ーメチレン)(2,1'ーイソ プロピリデン) ービス (インデニル) ジルコニウムジク ロリド、(1, 1'ーイソプロピリデン)(2, 2'ー メチレン) ービス (インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、(1,1'-メチレン)(2,2'-メチレン) (3-メチルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジ エニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-イソプ ロピリデン)(2,2'-イソプロピリデン)(3-メ 30 チルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-プロピリデン) (2, 2' -プロピリデン) (3-メチルシクロペンタ ジエニル) (シクロペンタジエニル)ジルコニウムジク ロリド、(1,1'-エチレン)(2,2'-メチレ ン) ービス (3-メチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1,1'ーメチレン)(2,2' ーエチレン) ービス (3-メチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-イソプロピ リデン) (2, 2'ーエチレン)ービス (3ーメチルシ 40 クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1'-エチレン)(2,2'-イソプロピリデン)-ビ ス (3-メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、(1,1'ーメチレン)(2,2'ーメチレ ン) ービス (3ーメチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1,1'ーメチレン)(2,2' ーイソプロピリデン) ービス (3ーメチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-イソ プロピリデン)(2,2'-イソプロピリデン)ービス (3-メチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジク 50 ム化合物であり、また、アタクチック構造のプロピレン

ロリド、(1,1' エチレン)(2,2' メチレ ン) ビス(3,4 ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'一エチレン) (2, 2' ーイソプロピリデン) ービス(3, 4ージメ チルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド。 (1, 1'ーメチレン)(2, 2'ーメチレン)ービス (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド,(1,1'-メチレン)(2,2'-イ ソプロピリデン) ービス (3, 4ージメチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-イ ソプロピリデン)(2,2'-イソプロピリデン)ービ ス(3、4ージメチルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-メチレン) ービス (3ーメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-エチレン) (2, 1'ーイソプロピリデン)ービス(3-メチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 2'-メチレン)(2,1'-メチレン)-ビス(3-メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、(1, 2'-メチレン)(2, 1'-イソプロピリ デン) – ビス (3ーメチルシクロペンタジエニル) ジル コニウムジクロリド、(1,2'ーイソプロピリデン) (2,1'-イソプロピリデン)ービス(3-メチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 2'-エチレン)(2,1'-メチレン)-ビス(3, 4 -ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、(1, 2' -エチレン)(2, 1' ーイソプロ ピリデン) ービス (3, 4ージメチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジクロリド,(1,2'ーメチレ ン) (2, 1'ーメチレン)ービス(3,4ージメチル シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド, (1, 2'-メチレン)(2, 1'-イソプロピリデ ン) ービス(3,4ージメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2'-イソプロピリデ ン) (2, 1'-イソプロピリデン) ービス(3,4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ドなど及びこれらの化合物におけるジルコニウムをチタ ン又はハフニウムに置換したものを挙げることができ る。もちろんこれらに限定されるものではない。 【0042】本発明における重合触媒においては、 (A)成分の遷移金属化合物として、好ましくは、前記 (A-1)成分(BASF型錯体又はヘキスト型錯 体), (A-2)成分(単架橋型錯体)、(A-3)成 分及び(A - 4)成分(二重架橋型錯体)の中から選ば れた少なくとも一種が用いられる。一種を用いる場合、 アイソタクチック構造のプロピレン系共重合体(I)を 製造するときは、(A-1)BASF型錯体,ヘキスト 型錯体、(A-2)单架橋型錯体、(A-4)二重架橋 型錯体が好ましく、更に好ましくは上記錯体のハフニウ 系共重合体(I)を製造するときは、(A 3)成分が 好ましい。二種以上を用いる場合は、特に、ジルコニウ ム化合物-ハフニウム化合物,ジルコニウム化合物-ジ ルコニウム化合物、ハフニウム化合物=ハフニウム化合 物の組み合わせが好適である。

25

【0043】このような組合わせの好適な例としては、 単架橋型ジルコニウム錯体-単架橋型ハフニウム錯体, BASF型ジルコニウム錯体-BASF型ハフニウム錯 体,ヘキスト型ジルコニウム錯体-ヘキスト型ハフニウ ム錯体,単架橋型ジルコニウム錯体-BASF型ハフニ 10 ウム錯体,単架橋型ジルコニウム錯体-ヘキスト型ハフ ニウム錯体,BASF型ジルコニウム錯体-単架橋型ハ フニウム錯体,ヘキスト型ジルコニウム錯体-単架橋型 ハフニウム錯体,BASF型ジルコニウム錯体-二重架 橋型ハフニウム錯体,ヘキスト型ジルコニウム錯体一二 重架橋型ハフニウム錯体,単架橋型ジルコニウム錯体-二重架橋型ハフニウム錯体,二重架橋型ジルコニウム錯 体-二重架橋型ハフニウム錯体,二重架橋型ジルコニウ ム錯体-BASF型ハフニウム触媒,二重架橋型ジルコ ニウム錯体--ヘキスト型ハフニウム触媒,二重架橋型ジ 20 ルコニウム錯体-単架橋型ハフニウム錯体,単架橋型ジ ルコニウム錯体-単架橋型ジルコニウム錯体,BASF 型ジルコニウム錯体-BASF型ジルコニウム錯体,へ キスト型ジルコニウム錯体-ヘキスト型ジルコニウム錯 体,BASF型ジルコニウム錯体-単架橋型ジルコニウ*

F型ジルコニウム錯体-単架橋型ジルコニウ* 【化12】
$$R^{28}$$
 $A 1 - O$ — ($A 1 - O$) $A 1 - O$ R^{28} R^{28}

は1~12のアルキル基, アルケニル基, アリール基, アリールアルキル基などの炭化水素基あるいはハロゲン 原子を示し、wは平均重合度を示し、通常2~50、好 ましくは2~40の整数である。なお、各R28は同じで※

【0048】(式中、R28及びwは前記一般式(V)に おけるものと同じである。)で示される環状アルミノキ サンを挙げることができる。前記アルミノキサンの製造 法としては、アルキルアルミニウムと水などの縮合剤と を接触させる方法が挙げられるが、その手段については 特に限定はなく、公知の方法に準じて反応させればよ い。例えば、①有機アルミニウム化合物を有機溶剤に溶 解しておき、これを水と接触させる方法、②重合時に当 初有機アルミニウム化合物を加えておき、後に水を添加 する方法、③金属塩などに含有されている結晶水、無機 物や有機物への吸着水を有機アルミニウム化合物と反応★

*ム錯体、ヘキスト型ジルコニウム錯体 単架橋型ジルコ ニウム錯体,BASF型ジルコニウム錯体 二重架橋型 ジルコニウム錯体,ヘキスト型ジルコニウム錯体一二重 架橋型ジルコニウム錯体,二重架橋型ジルコニウム錯体 - 単架橋型ジルコニウム錯体、二重架橋型ジルコニウム 錯体-二重架橋型ジルコニウム錯体,単架橋型ハフニウ ム錯体-単架橋型ハフニウム錯体,BASF型ハフニウ ム錯体―BASF型ハフニウム錯体, ヘキスト型ハフニ ウム錯体-ヘキスト型ハフニウム錯体,BASF型ハフ ニウム錯体-単架橋型ハフニウム錯体,ヘキスト型ハフ ニウム錯体-単架橋型ハフニウム錯体,BASF型ハフ ニウム錯体-二重架橋型ハフニウム錯体,ヘキスト型ハ フニウム錯体-二重架橋型ハフニウム錯体,二重架橋型 ハフニウム錯体-単架橋型ハフニウム錯体,二重架橋型 ハフニウム錯体-二重架橋型ハフニウム錯体などが挙げ られる。

【0044】本発明における重合触媒においては、

(B) 成分として、(B-1) アルミニウムオキシ化合 物、(B-2)前記遷移金属化合物と反応してカチオン に変換しうるイオン性化合物及び(B-3)粘土,粘土 鉱物又はイオン交換性層状化合物の中から選ばれた少な くとも一種が用いられる。上記 (B-1) 成分のアルミ ニウムオキシ化合物としては、一般式(V)

$$\frac{\mathbb{R}^{12}}{\mathbb{R}^{28}} \times \mathbb{R}^{28} \cdot \cdots \times \mathbb{R}^{28}$$

【0.046】 (式中、 R^{28} は炭素数 $1\sim20$ 、好ましく 30%も異なっていてもよい。) で示される鎖状アルミノキサ ン、及び一般式 (VI)

> [0047] 【化13】

[0045]

· · · (VI)

★させる方法、Φテトラアルキルジアルミノキサンにトリ 40 アルキルアルミニウムを反応させ、さらに水を反応させ る方法などがある。なお、アルミノキサンとしては、ト ルエン不溶性のものであってもよい。

【0049】これらのアルミニウムオキシ化合物は一種 用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。 一方、(B-2)成分としては、前記遷移金属化合物と 反応してカチオンに変換しうるイオン性化合物であれ ば、いずれのものでも使用できるが、特に効率的に重合 活性点を形成できるなどの点から、次の一般式(VII), (VIII)

$$((L^{1}-R^{29})^{h+})_{a} ((Z)^{-})_{b} \cdots (VII)$$

 $((L^2)^{h+})_a ((Z))_b$

(ただし、 L^2 は M^5 , $\mathrm{R}^{30}\,\mathrm{R}^{31}\,M^6\,,\mathrm{R}^{32}_3$ $\mathrm{C}\,\mathrm{X}\mathrm{tk}\mathrm{R}^{33}$ M⁶ である。)

[(VII), (VIII) 式中、L¹ はルイス塩基、〔Z〕⁻ は、非配位性アニオン〔 Z^1 〕 又は〔 Z^2 〕 、ここ で〔Z1〕 は複数の基が元素に結合したアニオン、す なわち [M⁴ G¹ G² · · · G^f] (ここで、M⁴ は周 期律表第5~15族元素、好ましくは周期律表第13~ 15族元素を示す。 $G^1 \sim G^f$ はそれぞれ水素原子,ハ ロゲン原子,炭素数 $1\sim20$ のアルキル基,炭素数 $2\sim~10~$ どを挙げることができる。また、 $M^5~$ の具体例として 40のジアルキルアミノ基、炭素数1~20のアルコキ シ基,炭素数6~20のアリール基,炭素数6~20の アリールオキシ基,炭素数7~40のアルキルアリール 基,炭素数7~40のアリールアルキル基,炭素数1~ 20のハロゲン置換炭化水素基,炭素数1~20のアシ ルオキシ基,有機メタロイド基、又は炭素数2~20の ヘテロ原子含有炭化水素基を示す。 $G^1 \sim G^f$ のうち2つ以上が環を形成していてもよい。fは〔(中心金属M 4 の原子価) +1〕の整数を示す。) 、〔Z²〕 は、 酸解離定数の逆数の対数 $(p \ K_a)$ が-10以下のブレ 20 シ基としてメトキシ基,エトキシ基,n-ブトキシ基, ンステッド酸単独又はブレンステッド酸及びルイス酸の 組合わせの共役塩基、あるいは一般的に超強酸と定義さ れる共役塩基を示す。また、ルイス塩基が配位していて もよい。また、R29は水素原子,炭素数1~20のアル キル基,炭素数6~20のアリール基,アルキルアリー ル基又はアリールアルキル基を示し、R30及びR31はそ れぞれシクロペンタジエニル基、置換シクロペンタジエ ニル基、インデニル基又はフルオレニル基、R32は炭素 数1~20のアルキル基,アリール基,アルキルアリー ル基又はアリールアルキル基を示す。R31はテトラフェ 30 ニルポルフィリン、フタロシアニンなどの大環状配位子 を示す。hは $\left(L^1-R^{27}\right)$, $\left(L^2\right)$ のイオン価数で $1\sim3$ の整数、aは1以上の整数、b=(h×a)であ る。M⁵ は、周期律表第1~3、11~13、17族元 素を含むものであり、M6 は、周期律表第7~12族元 素を示す。〕で表されるものを好適に使用することがで

【0050】ここで、L1 の具体例としては、アンモニ ア,メチルアミン,アニリン,ジメチルアミン,ジエチ ルアミン,N-メチルアニリン,ジフェニルアミン, N, Nージメチルアニリン, トリメチルアミン, トリエ チルアミン,トリーn-ブチルアミン,メチルジフェニ ルアミン、ピリジン、pーブロモーN、Nージメチルア ニリン, p-ニトローN, N-ジメチルアニリンなどの アミン類、トリエチルホスフィン、トリフェニルホスフ ィン、ジフェニルホスフィンなどのホスフィン類、テト ラヒドロチオフェンなどのチオエーテル類、安息香酸エ チルなどのエステル類、アセトニトリル,ベンゾニトリ ルなどのニトリル類などを挙げることができる。

【 $0\,0\,5\,1$ 】 R^{29} の具体例としては水素、メチル基、エ $*\,50$ 砒素($F\,S\,O_3$ $A\,s\,F_5$) , トリフルオロメタンス

· · · (VIII)

*チル基,ベンジル基,トリチル基などを挙げることがで き、R30, R31の具体例としては、シクロペンタジエニ ル基、メチルシクロペンタジエニル基、エチルシクロペ ンタジエニル基,ペンタメチルシクロペンタジエニル基 などを挙げることができる。R³²の具体例としては、フ ェニル基,p-トリル基,p-メトキシフェニル基など を挙げることができ、R³¹の具体例としてはテトラフェ ニルポルフィン,フタロシアニン,アリル,メタリルな は、Li, Na, K, Ag, Cu, Br, I, I3 など を挙げることができ、M6 の具体例としては、Mn, F e, Co, Ni, Znなどを挙げることができる。 【0052】また、 $(Z^1)^+$ 、すなわち $(M^4\ G^1\ G$ 2 . . . Gf) において、M⁴ の具体例としてはB, A 1, Si, P, As, Sbなど、好ましくはB及びA1 が挙げられる。また、 G^1 , G^2 $\sim G^f$ の具体例として は、ジアルキルアミノ基としてジメチルアミノ基、ジエ チルアミノ基など、アルコキシ基若しくはアリールオキ フェノキシ基など、炭化水素基としてメチル基,エチル 基,n-プロピル基,イソプロピル基,n-ブチル基, イソブチル基、n-オクチル基、n-エイコシル基、フ ェニル基,p-トリル基,ベンジル基,4-t-ブチル フェニル基、3、5-ジメチルフェニル基など、ハロゲ ン原子としてフッ素、塩素、臭素、ヨウ素、ヘテロ原子 含有炭化水素基としてp-フルオロフェニル基、3、5 ージフルオロフェニル基,ペンタクロロフェニル基, 3、4、5-トリフルオロフェニル基、ペンタフルオロ フェニル基,3,5ービス (トリフルオロメチル) フェ ニル基, ビス (トリメチルシリル) メチル基など、有機 メタロイド基としてペンタメチルアンチモン基、トリメ チルシリル基,トリメチルゲルミル基,ジフェニルアル シン基、ジシクロヘキシルアンチモン基、ジフェニル硼 素などが挙げられる。

【0053】また、非配位性のアニオンすなわちpKa が-10以下のブレンステッド酸単独又はブレンステッ ド酸及びルイス酸の組合わせの共役塩基〔Z²〕- の具 体例としてはトリフルオロメタンスルホン酸アニオン (CF3 SO3) - , ビス (トリフルオロメタンスルホ ニル) メチルアニオン,ビス (トリフルオロメタンスル ホニル) ベンジルアニオン、ビス (トリフルオロメタン スルホニル)アミド、過塩素酸アニオン(С1 O₄) - , トリフルオロ酢酸アニオン(CF3 C O_2)- , \land +サフルオロアンチモンアニオン(SbF_6) - , フルオロスルホン酸アニオン(FSO3) - , クロ ロスルホン酸アニオン (CISO3) , フルオロスル ホン酸アニオン、5-フッ化アンチモン (FSO3 /S bF5) - , フルオロスルホン酸アニオン/5ーフッ化

ルホン酸/5 フッ化アンチモン (CF3SO3/Sb F5) などを挙げることができる。

【0054】このような(B-2)成分の化合物の具体 例としては、テトラフェニル硼酸トリエチルアンモニウ ム,テトラフェニル硼酸トリーn-ブチルアンモニウ ム,テトラフェニル硼酸トリメチルアンモニウム,テト ラフェニル硼酸テトラエチルアンモニウム、テトラフェ ニル硼酸メチル (トリーnーブチル) アンモニウム,テ トラフェニル硼酸ベンジル (トリーn-ブチル) アンモ ニウム、テトラフェニル硼酸ジメチルジフェニルアンモ 10 わせて用いてもよい。(B-3)成分として、粘土、粘 ニウム, テトラフェニル硼酸トリフェニル (メチル) ア ンモニウム, テトラフェニル硼酸トリメチルアニリニウ ム,テトラフェニル硼酸メチルピリジニウム,テトラフ ェニル硼酸ベンジルピリジニウム,テトラフェニル硼酸 メチル (2-シアノピリジニウム), テトラキス (ペン タフルオロフェニル) 硼酸トリエチルアンモニウム, テ トラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリーn-ブ チルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸トリフェニルアンモニウム, テトラキス (ペン タフルオロフェニル) 硼酸テトラーn-ブチルアンモニ 20 ウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸テト ラエチルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) 硼酸ベンジル (トリーnーブチル) アンモニウ ム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチル ジフェニルアンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロ フェニル) 硼酸トリフェニル (メチル) アンモニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチルアニ リニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 ジメチルアニリニウム, テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) 硼酸トリメチルアニリニウム, テトラキス (ペ 30 ンタフルオロフェニル) 硼酸メチルピリジニウム, テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ベンジルピリジ ニウム, テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メ チル (2-シアノピリジニウム), テトラキス (ペンタ フルオロフェニル) 硼酸ベンジル (2-シアノピリジニ ウム), テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メ チル(4ーシアノピリジニウム) , テトラキス (ペンタ フルオロフェニル) 硼酸トリフェニルホスホニウム, テ トラキス (ビス (3, 5ージトリフルオロメチル) フェ ニル〕硼酸ジメチルアニリニウム、テトラフェニル硼酸 40 フェロセニウム,テトラフェニル硼酸銀,テトラフェニ ル硼酸トリチル,テトラフェニル硼酸テトラフェニルポ ルフィリンマンガン、テトラキス (ペンタフルオロフェ ニル) 硼酸フェロセニウム, テトラキス (ペンタフルオ ロフェニル) 硼酸(1,1'-ジメチルフェロセニウ ム) , テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸デカ メチルフェロセニウム、テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) 硼酸銀、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸トリチル、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸リチウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ 50 を層間の中に確保することも可能である。

ル) 硼酸ナトリウム、テトラキス (ペンタフルオロフェ ニル)硼酸テトラフェニルポルフィリンマンガン、テト ラフルオロ硼酸銀、ヘキサフルオロ燐酸銀、ヘキサフル オロ砒素酸銀、過塩素酸銀、トリフルオロ酢酸銀、トリ フルオロメタンスルホン酸銀などを挙げることができ

【0055】この (B-2) 成分である、該 (A) 成分 の遷移金属化合物と反応してカチオンに変換しうるイオ ン性化合物は一種用いてもよく、また二種以上を組み合 土鉱物又はイオン交換性層状化合物が用いられる。粘土 とは、細かい含水ケイ酸塩鉱物の集合体であって、適当 量の水を混ぜてこねると可塑性を生じ、乾くと剛性を示 し、高温度で焼くと焼結するような物質をいう。また、 粘土鉱物とは、粘土の主成分をなす含水ケイ酸塩をい う。イオン交換性層状化合物とは、イオン結合等によっ て構成される面が互いに弱い結合力で平行に積み重なっ た結晶構造をとる化合物であり、含有するイオンが交換 可能なものをいう。大部分の粘土鉱物は、イオン交換性 層状化合物である。これらは、天然産のものに限らず、 人工合成したものであってもよい。イオン交換性層状化 合物として、例えば、六方最密パッキング型、アンチモ ン型、塩化カドミウム型、ヨウ化カドミウム型等の層状 の給晶構造を有するイオン結品性化合物等を挙げること ができる。

【0056】(B-3)成分の具体例としては、カオリ ン、ベントナイト、木節粘土、ガイロメ粘土、アロフェ ン、ヒシンゲル石、パイロフィライト、タルク、ウンモ 群、モンモリロナイト群、バーミキュライト、リョクデ イ石群、パリゴルスカイト、ナクライト、ディッカイ ト、ハロイサイト等が挙げられる。(B-3)成分とし ては、水銀圧入法で測定した半径20Å以上の細孔容積 が、0.1ミリリットル/g以上、特には、0.3~5ミリ リットル/g以上のものが好ましい。また、粘土中の不 純物除去又は構造及び機能の変化という点から、化学処 理を施すことも好ましい。ここで、化学処理とは、表面 に付者している不純物を除去する表面処理と粘土の結晶 構造に影響を与える処埋の何れをもさす。具体的には、 酸処理、アルカリ処理、塩類処理、有機物処埋等が挙げ られる。酸処理は表面の不純物を取り除く他、結晶構造 中のアルミニウム、鉄、マグネシウム等の陽イオンを溶 出させることによって表面積を増大させる。アルカリ処 理では粘土の結晶構造が破壊され、粘土の構造の変化を もたらす、また、塩類処理、有機物処理では、イオン複 合体、分子複合体、有機複合体などを形成し、表面積や 層間距離等を変化させることができる。イオン交換性を 利用し、層間の交換性イオンを別の嵩高いイオンと置換 することによって、層間が拡大された状態の層間物質を 得ることもでさる。まだ、主触媒が存在する重合反応場

【0057】上記(B 3)成分はそのまま用いてもよ いし、新たに水を添加吸着させたものを用いてもよく、 あるいは加熱脱水処埋里したものを用いてもよい。(B -3)成分として、好ましいものは粘土または粘土鉱物 であり、最も好ましいものはモンモリロナイトである。 (B-3)成分は、シラン系化合物及び、/又は有機アル ミニウム化合物により処理することが好ましい。この処 理により、活性が向上することがある。このシラン系化 合物としては、例えば、トリメチルシリルクロリド,ト リエチルシリルクロリド,トリイソプロピルシリルクロ 10 れる直鎖状アルミノキサン又は上記一般式(VI)で表さ リド、tertーブチルジメチルシリルクロリド、te rt-ブチルジフェニルシリルクロリド, フェネチルジ メチルシリルクロリド等のトリアルキルシリルクロリド 類、ジメチルシリルジクロリド、ジエチルシリルジクロ リド、ジイソプロピルシリルジクロリド、ビスジフェネ チルシリルジクロリド,メチルフェネチルシリルジクロ リド、ジフェニルシリルジクロリド、ジメシチルシリル ジクロリド、ジトリルシリルジクロリド等のジアルキル シリルジクロリド類、メチルシリルトリクロリド、エチ ルシリルトリクロリド、イソプロピルシリルトリクロリ 20 ハロゲン、アルコキシ基あるいは水酸基含有のアルキル ド、フェニルシリルトリクロリド、メシチルシリルトリ クロリド,トリルシリルトリクロリド,フェネチルシリ ルトリクロリド等のアルキルシリルトリクロリド類、及 び上記クロリドの部分を他のハロゲン元素で置き換えた ハライド類、ビス (トリメチルシリル) アミン, ビス (トリエチルシリル) アミン, ビス (トリイソプロピル シリル) アミン, ビス (ジメチルエチルシリル) アミ ン, ビス (ジエチルメチルシリル) アミン, ビス (ジメ チルフェニルシリル) アミン, ビス (ジメチルトリルシ リル) アミン, ビス (ジメチルメシチルシリル) アミ ン、N, Nージメチルアミノトリメチルシラン,(ジエ チルアミノ) トリメチルシラン、N-(トリメチルシリ ル) イミダゾール等のシリルアミン類、パーアルキルポ リシロキシポリオールの慣用名で称せられるポリシラノ ール類、トリス (トリメチルシロキシ) シラノール等の シラノール類、N, O-ビス (トリメチルシリル) アセ トアミド, ビス (トリメチルシリル) トリフルオロアセ トアミド, N- (トリメチルシリル) アセトアミド, ビ ス (トリメチルシリル) 尿素, トリメチルシリルジフェ ニル尿素等のシリルアミド傾、1,3-ジクロロテトラ 40 メチルジシロキサン等の直鎖状シロキサン類、ペンタメ チルシクロペンタンシロキサン等の環状シロキサン類、 ジメチルジフェニルシラン, ジエチルジフェニルシラ ン、ジイソプロピルジフェニルシラン等のテトラアルキ ルシラン類、トリメチルシラン,トリエチルシラン,ト リイソプロピルシラン,トリー t ーブチルシラン,トリ フェニルシラン,トリトリルシラン,トリメシチルシラ ン、メチルジフェニルシラン、ジナフチルメチルシラ ン, ビス (ジフェニル) メチルシラン等のトリアルキル

化合物が挙げられる。これらのうち、好ましくはシリル アミン類であり、より好ましくはトリアルキルシランク ロリド類である。シラン系化合物は、これらの内から一 種類用いてもよいが、場合によっては二種類以上を任意 に組み合わせて用いることも可能である。

【0058】さらに、(B-3)成分の処理に用いる有 機アルミニウム化合物としては特に制限はないが、例え ば、後述する一般式(IX)と同様の式で表されるアルキ ル基含有アルミニウム化合物、上記一般式(V)で表さ れる環状アルミノキサンもしくは環状アルミノキサンの 会合体を好ましく用いることができる。貝体的には、ト リメチルアルミニウム,トリエチルアルミニウム,トリ プロピルアルミニウム,トリイソブチルアルミニウム, トリーt - ブチルアルミニウム等のトリアルキルアルミ ニウム、ジメチルアルミニウムクロリド、ジエチルアル ミウムクロリド,ジメチルアルミニウムメトキシド,ジ エチルアルミニウムメトキシド,ジメチルアルミニウム ヒドロキシド、ジエチルアルミニウムヒドロキシド等の アルミニウム、ジメチルアルミニウムヒドリド,ジイソ ブチルアル・ミニウムヒドリド等の水素原子含有のアルキ ルアルミニウム、メチルアルミノキサン,エチルアルミ ノキサン、イソブチルアルミノキサン等のアルミノキサ ン等であり、これらのうち、特にトリメチルアルミニウ ムあるいはトリイソブチルアルミニウムが好ましい。 (B-3)成分の処理に用いる有機アルミニウム化合物 は、これらの内から一種用いてもよく、二種以上を組み 合わせて用いてもよい。

【0059】(B-3)成分の処理に用いるシラン系化 合物及び有機アルミニウム化合物の使用割合については 特に制限はないが、(B-3)成分が粘土または粘土鉱 物の場合は、(B-3)成分中の水酸基1モルに対し、 シラン系化合物中のケイ素原手が通常0.1~10000 0モル、好ましくは0.5~10000モルとなる割合 で、また有機アルミニウム化台物を用いる場合は、有機 アルミニウム化合物中のアルミニウム原子が通常0.1~ 100000モル、好ましくは0.5~10000モルと なる割合で用いられる。また、(B-3)成分が粘土又 は粘土鉱物以外の場合は、(B-3)成分1gに対し、 シラン系化合物中のケイ素原子が0.001~100gと なる割合で、また有機アルミニウム化合物を用いる場合 は、有機アルミニウム化合物中のアルミニウム原子が0. 001~100gとなる割合で用いことが好ましい。上 記の割合の範囲外では重合活性が低下することがある。 (B-3)成分の処理は、窒素等の不活性気体中あるい はペンタン、ヘキサン、トルエン、キシレン等の炭化水 素中で行ってもよい。さらに、この処理は、重合温度下 で行うことができることはもちろん、−30℃から使用 シラン類、四塩化ケイ素,四臭化ケイ素等の無機ケイ素 50 溶媒の沸点の間、特に室温から使用溶媒の沸点の間で行

うことが好ましい。

【0060】本発明における重合触媒においては、この(B)成分として、(B-1)成分、(B-2)成分、(B-3)成分を単独で用いてもよく、また、これらを組み合わせて用いてもよい。この予備重合触媒における(A)触媒成分と(B)触媒成分との使用割合は、

(B) 触媒成分として(B-1)化合物を用いた場合には、モル比で好ましくは1:1~1:10⁶、より好ましくは1:10~1:10⁴の範囲が望ましく、上記範囲を逸脱する場合は、単位重量ポリマーあたりの触媒コ 10ストが高くなり、実用的でない。(B-2)化合物を用いた場合には、モル比で好ましくは10:1~1:100、より好ましくは2:1~1:10の範囲が望ましい。この範囲を逸脱する場合は単位重量ポリマーあたりの触媒コストが高くなり、実用的でない。また、(B-3)化合物として粘土又は粘土鉱物を用いた場合、

(A)触媒成分と(B)触媒成分中の水酸基のモル比で好ましくは1:0.1~1:100000、より好ましくは1:0.5~1:10000の範囲が望ましい。さらに、(B-3)化合物としてイオン交換性層状化合物を20用いた場合、(A)触媒成分と(B)触媒成分の使用割合は、重量比で好ましくは1:1~1:100000である。この範囲を逸脱する場合は単位重量ボリマー当たりの触媒コストが高くなり、実用的でない。

【0061】重合触媒は、前記の(A)成分及び(B)成分を主成分として含有するものであってもよいし、また、(A)成分及び(B)成分と共に(C)有機アルミニウム化合物を含有するものであってもよい。ここで、(C)成分の有機アルミニウム化合物としては、一般式(IX)

 $R^{33}s$ AlQ_{3-s} · · · (IX)

(式中、R33は炭素数1~10のアルキル基、Qは水素原子、炭素数1~20のアルコキシ基、炭素数6~20のアリール基又はハロゲン原子を示し、sは1~3の整数である。但し、複数のR33は同一でも異なってもよい。)で示される化合物又はアルミノキサンが用いられる。

【0062】前記一般式 (IX) で示される化合物の具体 関としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブロピルアルミニウム、トリイソブ 40 になる。また、担体の比表面積は、通常1~1000m チルアルミニウムクロリド、ジメチルアルミニウムクロリド、ジ 40 になる。また、担体の比表面積は、通常1~1000m 2 / g、好ましくは50~500m² / g、粉ましくは0.3~3cm³ / gである。比表面積又は細孔容積のいずれかが上記範囲 を逸脱すると、触媒活性が低下することがある。なお、比表面積及び細孔容積は、例えば、BET法に従って吸 ムセスキクロリドなどが挙げられる。これらの有機アルミニウム化合物は一種用いてもよく、二種以上を組合せて用いてもよい。前記(A)触媒成分と(C)触媒成分との使用割合は、モル比で好ましくは1:1~1:20 00、より好ましくは1:5~1:1000、さらに好 50 0℃、好ましくは140~800℃で焼成して用いるこ

ましくは1:10~1:500の範囲が望ましい。該 (C) 触媒成分を用いることにより、遷移金属当たりの 重合活性を向上させることができるが、あまり多いと有 機アルミニウム化合物が無駄になるとともに、重合体中 に多量に残存し、好ましくない。

【0063】本発明においては、触媒成分の少なくとも 一種を適当な担体に担持して用いることができる。該担 体の種類については特に制限はなく、無機酸化物担体、 それ以外の無機担体及び有機担体のいずれも用いること ができるが、特に無機酸化物担体あるいはそれ以外の無 機担体が好ましい。無機酸化物担体としては、具体的に は、SiO2 , Al2 O3 , MgO, ZrO2 , TiO 2 , Fe₂ O₃ , B₂ O₃ , CaO, ZnO, BaO, ThO2 やこれらの混合物、例えばシリカアルミナ、ゼ オライト,フェライト,セピオライト,グラスファイバ ーなどが挙げられる。これらの中では、特にSiO2, A 12 O3 が好ましい。なお、上記無機酸化物担体は、 少量の炭酸塩,硝酸塩,硫酸塩などを含有してもよい。 【0064】一方、上記以外の担体として、MgC 12 , Mg (OC2 H5)2 などのマグネシウム化合物な どで代表される一般式Mg R34x X8 y で表されるマグ ネシウム化合物やその錯塩などを挙げることができる。 ここで、R34は炭素数1~20のアルキル基、炭素数1 ~20のアルコキシ基又は炭素数6~20のアリール 基、X8 はハロゲン原子又は炭素数1~20のアルキル 基を示し、xは0~2、yは0~2でり、かつx+y= 2である。各R34及び各X8 はそれぞれ同一でもよく、 また異なってもいてもよい。また、有機担体としては、 ポリスチレン,置換ポリスチレン,スチレン-ジビニル 30 ベンゼン共重合体, ポリエチレン, ポリプロピレン, ポ リアリレートなどの重合体やスターチ、カーボンなどを 挙げることができる。ここで用いられる担体としては、 $MgCl_2$ 、MgCl (OC₂ H₅)、Mg (OC₂ H₅) 2 、SiO2 、Al2 O3 などが好ましい。また担体の 性状は、その種類及び製法により異なるが、平均粒径は 通常1~300µm、好ましくは10~200µm、よ り好ましくは20~100μmである。 粒径が小さいと 重合体中の微粉が増大し、粒径が大きいと重合体中の粗 大粒子が増大し嵩密度の低下やホッパーの詰まりの原因 になる。また、担体の比表面積は、通常 $1\sim1000$ m ² /g、好ましくは50~500m² /g、細孔容積は 通常0.1~5 c m³/g、好ましくは0.3~3 c m³/ gである。比表面積又は細孔容積のいずれかが上記範囲 を逸脱すると、触媒活性が低下することがある。なお、 比表面積及び細孔容積は、例えば、BET法に従って吸 着された窒素ガスの体積から求めることができる(ジャ ーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサィエテ ィ, 第60巻, 第309ページ (1983年) 参照)。 【0065】さらに、上記担体は、通常120~100

とが望ましい。触媒成分の少なくとも一種を前記担体に 担持させる場合、(A)触媒成分及び(B)触媒成分の 少なくとも一方を、好ましくは(A)触媒成分及び

(B) 触媒成分の両方を担持させるのが望ましい。該担 体に、(A)成分及び(B)成分の少なくとも一方を担 持させる方法については、特に制限されないが、例えば **Φ** (A) 成分及び (B) 成分の少なくとも一方と担体と を混合する方法、②担体を有機アルミニウム化合物又は ハロゲン含有ケイ素化合物で処理したのち、不活性溶媒 中で(A)成分及び(B)成分の少なくとも一方と混合 する方法、3担体と(A)成分及び/又は(B)成分と 有機アルミニウム化合物又はハロゲン含有ケイ素化合物 とを反応させる方法、④(A)成分又は(B)成分を担 体に担持させたのち、(B)成分又は(A)成分と混合 する方法、⑤(A)成分と(B)成分との接触反応物を 担体と混合する方法、⑥(A)成分と(B)成分との接 触反応に際して、担体を共存させる方法などを用いるこ とができる。なお、上記40、60及び60の反応において、 (C) 成分の有機アルミニウム化合物を添加することも できる。このようにして得られた触媒は、いったん溶媒 20 留去を行って固体として取り出してから重合に用いても よいし、そのまま重合に用いてもよい。

【0066】また、本発明においては、(A)成分及び (B) 成分の少なくとも一方の担体への担持操作を重合 系内で行うことにより触媒を生成させることができる。 例えば (A) 成分及び (B) 成分の少なくとも一方と担 体とさらに必要により前記 (C)成分の有機アルミニウ ム化合物を加え、原料単量体を常圧~20kg/cm² 加えて、−20〜200℃で1分〜10時間程度予備重 合を行い**触媒**粒子を生成させる方法を用いることができ 30 る。本発明においては、前記化合物(B-1)成分と担 体との使用割合は、好ましくは1:0.5~1:1000 0、より好ましくは1:1~1:500とするのが望ま しく、(B-2)成分と担体との使用割合は、重量比で 好ましくは10-7:1~10-2:1、より好ましくは1 O-5:1~1O-3:1とするのが望ましい。また、(B -3)成分と担体との使用割合は、重量比で好ましくは 1:10~1:10000、より好ましくは1:10~ 1:1000とするのが望ましい。 さらに (A) 成分と 担体との使用割合は、重量比で好ましくは1:5~1: 1000000、より好ましくは1:10~1:100 00とするのが望ましい。

【0067】該(B)成分〔(B-1)成分,(B-2)成分又は(B-3)成分〕と担体との使用割合、又は(A)成分と担体との使用割合が上記範囲を逸脱すると、活性が低下することがある。このようにして調製された重合用触媒の平均粒径は、通常 $2\sim200\mu$ m、好ましくは $10\sim150\mu$ m、特に好ましくは $20\sim100\mu$ mであり、比表面積は、通常 $20\sim1000$ m²/g、好ましくは $50\sim500$ m²/gである。平均粒径 50 などのジハロゲン化ジアルコキシチタン、ト チタニウムクロリド,ト リプロボキシチタニウムクロリド、ト トキシチタニウムクロリドなどのモノハロゲルコキシチタンなどが挙げられるが、これら ロゲン含有チタン化合物、特に四塩化チタン る。またこれらのチタン化合物は一種だけて く、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

が2μm未満であると重合体中の微粉が増大することがあり、200μmを超えると重合体中の粗大粒子が増大することがある。比表面積が20m²/g未満であると活性が低下することがあり、1000m²/gを超えると重合体の嵩密度が低下することがある。また、該触媒において、担体100g中の遷移金属量は、通常0.05~10g、特に0.1~2gであることが好ましい。遷移金属量が上記範囲外であると、活性が低くなることがある。このように担体に担持することによって工業的に有利な高い嵩密度と優れた粒径分布を有する重合体を得ることができる。

【0068】プロピレン系グラフト共重合体(II)を製 造する場合は、重合触媒として、末端に二重結合を形成 しないようなものを、前記重合触媒の中から選び用いる のが望ましい。また、重合触媒としては、上述した重合 触媒のほかに、チタン,マグネシウム及び電子供与性化 合物からなる固体触媒成分、有機アルミニウム化合物並 びに第三成分としての電子供与性化合物からなる重合触 媒(以下、単にチタン-マグネシウム系触媒ということ がある)を用いることができる。ここで、固体触媒成分 は、少なくとも (a) チタン化合物と (b) マグネシウ ム化合物と(c)電子供与性化合物とからなるものであ る。(a)成分として用いられるチタン化合物として は、例えば一般式 TiXºt (OR³5)4-t (式中、 X9はハロゲン原子、R35は炭素数1~10の炭化水素 基、tは0~4の整数を示す。OR35が複数存在する場 合、各R³⁵は同一でも異なっていてもよい。)で表され る化合物を挙げることができる。このようなチタン化合 物の例としては、テトラメトキシチタン,テトラエトキ シチタン, テトラーnープロポキシチタン, テトライソ プロポキシチタン,テトラーn-ブトキシチタン,テト ライソブトキシチタン, テトラシクロヘキシロキシチタ ン,テトラフェノキシチタンなどのテトラアルコキシチ タン、四塩化チタン,四臭化チタン,四ヨウ化チタンな どのテトラハロゲン化チタン、メトキシチタニウムトリ クロリド, エトキシチタニウムトリクロリド, プロポキ シチタニウムトリクロリド,n-ブトキシチタニウムト リクロリド, エトキシチタニウムトリブロミドなどのト リハロゲン化モノアルコキシチタン、ジメトキシチタニ ウムジクロリド,ジエトキシチタニウムジクロリド,ジ プロポキシチタニウムジクロリド, ジーnーブトキシチ タニウムジクロリド,ジエトキシチタニウムジブロミド などのジハロゲン化ジアルコキシチタン、トリメトキシ チタニウムクロリド,トリエトキシチタニウムクロリ ド,トリプロポキシチタニウムクロリド,トリーn-ブ トキシチタニウムクロリドなどのモノハロゲン化トリア ルコキシチタンなどが挙げられるが、これらの中で高ハ ロゲン含有チタン化合物、特に四塩化チタンが好適であ る。またこれらのチタン化合物は一種だけで用いてもよ

【0069】また、上記固体触媒成分における(b)成 分のマグネシウム化合物としては、例えば一般式 Mg R36 R37 〔式中、R36 及びR37は、それぞれハロゲン 原子、炭化水素基又はOR基(Rは炭化水素基)を示 し、それらはたがいに同一であっても異なっていてもよ い。〕で表される化合物を挙げることができる。上記一 般式において、R36及びR37のうちのハロゲン原子とし ては、塩素、臭素、ヨウ素及びフッ素原子が挙げられ る。また、R36及びR37のうちの炭化水素基やRで示さ れる炭化水素基としては、例えば炭素数1~12のアル 10 キル基、炭素数5~12のシクロアルキル基、炭素数6 $\sim \! 1 \, 2$ のアリール基,炭素数 $7 \! \sim \! 1 \, 2$ のアラルキル基な どが挙げられる。

【0070】このようなマグネシウム化合物の例として は、ジメチルマグネシウム,ジエチルマグネシウム,ジ イソプロピルマグネシウム,ジブチルマグネシウム,ジ ヘキシルマグネシウム,ジオクチルマグネシウム,ブチ ルエチルマグネシウム,ジフェニルマグネシウム,ジシ クロヘキシルマグネシウム,ジメトキシマグネシウム, ジエトキシマグネシウム、ジブトキシマグネシウム、ジ 20 ル基、アリル基、プロペニル基、ブテニル基などの炭素 ヘキソキシマグネシウム、ジオクトキシマグネシウム、 ジフェノキシマグネシウム, ジシクロヘキソキシマグネ シウム,エチルマグネシウムクロリド,ブチルマグネシ ウムクロリド, ヘキシルマグネシウムクロリド, イソブ チルマグネシウムクロリド、tert-ブチルマグネシ ウムクロリド, フェニルマグネシウムクロリド, ベンジ ルマグネシウムクロリド,エチルマグネシウムブロミ ド,ブチルマグネシウムブロミド,フェニルマグネシウ ムブロミド,ブチルマグネシウムヨージド,エトキシマ グネシウムクロリド,ブトキシマグネシウムクロリド, ヘキソキシマグネシウムクロリド,フェノキシマグネシ ウムクロリド, エトキシマグネシウムブロミド, ブトキ シマグネシウムブロミド, エトキシマグネシウムヨージ ド,マグネシウムジクロリド,マグネシウムジブロミ ド、マグネシウムジヨージドなどが挙げられる。

【0071】上記マグネシウム化合物は、金属マグネシ ウム又はその他のマグネシウム化合物から調製すること もできる。このような方法の例としては、金属マグネシ ウムにハロゲン化物及び一般式 Xn M (OR38) m-n

(式中、Xは水素原子,ハロゲン原子又は炭素数1~ 40 20の炭化水素基、Mはホウ素、炭素、アルミニウム、 珪素又はリン原子、R38は炭素数1~20の炭化水素 基、mはMの原子価、nはO以上m未満の整数を示す。 Xが複数ある場合、各Xは同一でも異なっていてもよ く、またOR38が複数ある場合、各OR38は同一でも異 なっていてもよい。)で表されるアルコキシ基含有化合 物とハロゲン化物を接触させる方法が挙げられる。この 一般式において、Xのうちの炭素数1~20の炭素水素 基及びR38で示される炭素数1~20の炭素水素基とし ては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イ 50 テトラヒドロナフタレン-2、3-ジカルボン酸:イン

ソプロピル基、n ブチル基、イソブチル基、ヘキシル 基、オクチル基などの炭素数1~20のアルキル基、シ クロヘキシル基などの炭素数5~20のシクロアルキル 基、アリル基,プロペニル基,ブテニル基などの炭素数 2~20のアルケニル基、フェニル基、トリル基、キシ リル基などの炭素数6~20のアリール基、ベンジル 基,フェネチル基,3-フェニルプロピル基などの炭素 数7~20のアラルキル基などが挙げられる。 これらの 中で、特に炭素数1~10のアルキル基が好ましい。 【0072】また、他の例としては、一般式 Mg(O R³⁹) 2 (式中、R³⁹は炭素数1~20の炭化水素基 を示し、2つのOR³⁹は同一でも異なっていてもよ い。)で表されるマグネシウムアルコキシ化合物にハロ ゲン化物を接触させる方法が挙げられる。上記一般式に おいて、R39で示される炭素数1~20の炭化水素基と しては、例えばメチル基、エチル基、nープロピル基、 イソプロピル基,n-ブチル基,イソブチル基,ヘキシ ル基、オクチル基などの炭素数1~20のアルキル基、 シクロヘキシル基などの炭素数5~20のシクロアルキ 数2~20のアルケニル基、フェニル基, トリル基, キ シリル基などの炭素数6~20のアリール基、ベンジル 基, フェネチル基, 3-フェニルプロピル基などの炭素 数7~20のアラルキル基などが挙げられる。 これらの 中で、特に炭素数1~10のアルキル基が好ましい。こ れらの方法におけるハロゲン化物の例としては、四塩化 珪素,四臭化珪素,四塩化錫,四臭化錫,塩化水素など が挙げられるが、これらの中で、特に四塩化珪素が好ま しい。この (b) 成分のマグネシウム化合物は、単独で 用いても二種以上を組み合わせて用いてもよく、また、 シリカ、アルミナ、ポリスチレンなどの支持体に担持し て用いてもよいし、さらにはハロゲン化合物などとの混 合物として用いてもよい。

【0073】さらに、上記固体触媒成分における(c) 成分の電子供与性化合物としては、例えばアルコール 類、フェノール類、ケトン類、アルデヒド類、有機酸 類、さらには有機酸や無機酸のエステル類,モノエーテ ル,ジエーテル,ポリエーテルなどのエーテル類などの 含酸素電子供与体、アンモニア,アミン類,ニトリル 類、イソシアネート類などの含窒素電子供与体などが挙 げられるが、これらの中で多価カルボン酸のエステル化 合物、特に芳香族ジカルボン酸のジエステル誘導体が好 ましい。ここで、芳香族ジカルボン酸のジエステル誘導 体は、エステル部の有機基が直鎖状,分岐状,環状の脂 肪族炭化水素基であるものが好ましい。

【0074】このようなものとしては、例えばフタル 酸;ナフタレン-1,2-ジカルボン酸;ナフタレン-2, 3-ジカルボン酸; 5, 6, 7, 8-テトラヒドロ ナフタレンー1,2ージカルボン酸;5,6,7,8ー

ダン 4,5 ジカルボン酸;インダン・5,6 ジカ ルボン酸などのメチル;エチル; n プロピル;イソプ ロビル;nーブチル;イソブチル、tーブチル;nーペ ンチル;1ーメチルブチル;2ーメチルブチル;3ーメ チルブチル;1,1-ジメチルプロピル;1-メチルペ ンチル; 2-メチルペンチル; 3-メチルペンチル; 4 - メチルペンチル;1-エチルブチル;2-エチルブチ ル;3-エチルブチル;n-ヘキシル;シクロヘキシ ル;nーヘプチル;n-オクチル;n-ノニル;2-メ チルヘキシル;3-メチルヘキシル;4-メチルヘキシ 10 ペンチル基;2-メチルシクロペンチル基;3-メチル ル;2-エチルヘキシル;3-エチルヘキシル;4-エ チルヘキシル;2ーメチルペンチル;3ーメチルペンチ ル;2-エチルペンチル;3-エチルペンチルなどのジ アルキルエステルが挙げられる。これらの中で、特にフ タル酸ジエステル誘導体が好適であり、またエステル部 の有機基が炭素数4以上の直鎖状又は分岐状のアルキル 基であるものが好適である。この具体例としては、フタ ル酸ジーnーブチル、フタル酸ジエチルを挙げることが できる。

用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。 本発明で用いられるチタン-マグネシウム系触媒におけ る固体触媒成分は、前記(a)成分のチタン化合物と (b) 成分のマグネシウム化合物と(c) 成分の電子供 与性化合物とを接触させることによって調製することが できる。この際、電子供与性化合物は、マグネシウム原 子に対するモル比が、通常0.01~10、好ましくは0. 05~1.0になるように接触させるのが有利であり、ま た、チタン化合物は、マグネシウム原子に対するモル比 が、通常0.5~100、好ましくは1~50になるよう 30 に接触させるのが有利である。接触温度は特に制限はな いが、通常-20~200℃、好ましくは20~150 ℃の範囲で選定される。また、接触時間は接触温度など により左右され、一概に定めることはできないが、通常 は1分~24時間、好ましくは10分~6時間程度であ る。なお、接触手順については特に制限はなく、様々な 手順で行うことができる。

【0076】各成分を接触後、炭化水素などの不活性溶 剤を用いて固体触媒成分を洗浄してもよい。また、接触 の際に、炭化水素などの不活性溶剤で希釈してもよい。 また、チタン化合物の接触,反応を2回以上行い、触媒 担体としての役割をするマグネシウム化合物に十分担持 させるのがよい。このようにして調製された固体触媒成 分は、乾燥状態で保存してもよく、また炭化水素などの 不活性溶剤中で保存してもよい。また、上記固体触媒成 分は、(a)成分、(b)成分及び(c)成分に加え て、場合により(d)成分として、例えば一般式 R40 a R^{41}_b Si $(OR^{42})_{4-a-b}$ (式中、 R^{40} , R^{41} 及び R42は、それぞれ炭素数1~20の炭化水素基を示し、 それらは同一でも異なっていてよく、a及びbは、それ 50 ン, ジ(3-エチルシクロペンチル)ジメトキシシラ

ぞれ1又は2を示し、それらの合計は3以下である。) で表される有機珪素化合物を用いることもできる。ここ で、上記一般式中のR40, R41及びR42で示される炭素 数1~20の炭化水素基としては、例えばメチル基, エ チル基、nープロピル基、nーブチル基などの直鎖状炭 化水素基、イソプロピル基、イソブチル基、tert-ブチル基,sec-ブチル基などの分岐状炭化水素基、 あるいは環状炭化水素基、ビニル基、アリール基などが 挙げられる。この環状炭化水素基の例としては、シクロ シクロペンチル基;2-エチルシクロペンチル基;2n-プロピルシクロペンチル基;2,3-ジメチルシク ロペンチル基;2,4ージメチルシクロペンチル基; 2,5-ジメチルシクロペンチル基;2,3-ジエチル シクロペンチル基;2,4-ジエチルシクロペンチル 基;2,5-ジエチルシクロペンチル基;2,3,4-トリメチルシクロペンチル基;2,3,5-トリメチル シクロペンチル基;2,3,4-トリエチルシクロペン チル基 ; テトラメチルシクロペンチル基 ; テトラエチル 【0075】この(c)成分の電子供与性化合物は一種 20 シクロペンチル基;シクロヘキシル基;2-メチルシク ロヘキシル基;3-メチルシクロヘキシル基;4-メチ ルシクロヘキシル基;2-エチルシクロヘキシル基;2 -n-プロピルシクロヘキシル基;2,3-ジメチルシ クロヘキシル基;2,4ージメチルシクロヘキシル基; 2,5-ジメチルシクロヘキシル基;2,6-ジメチル シクロヘキシル基;2,3-ジエチルシクロヘキシル 基;2,4-ジエチルシクロヘキシル基;2,5-ジエ チルシクロヘキシル基;2,6-ジエチルシクロヘキシ ル基;2,3,4ートリメチルシクロヘキシル基;2, 3,5-トリメチルシクロヘキシル基;2,3,6-ト リメチルシクロヘキシル基;2,4,5-トリメチルシ クロヘキシル基;2,4,6-トリメチルシクロヘキシ ル基: 2, 3, 4-トリエチルシクロヘキシル基: 2, 3, 4, 5-テトラメチルシクロヘキシル基; 2, 3, 4、6ーテトラメチルシクロヘキシル基;2、3、5、 6-テトラメチルシクロヘキシル基;2,3,4,5-テトラエチルシクロヘキシル基 ; ペンタメチルシクロヘ キシル基;ペンタエチルシクロヘキシル基などが挙げら れる。

> 【0077】また、R⁴⁰, R⁴¹及びOR⁴²が、それぞれ 複数ある場合、各R40は同一でも異なっていてもよく、 また各R*1は同一でも異なっていてもよい。さらに、各 OR42は同一でも異なっていてもよい。このような有機 珪素化合物の例としては、ジセーブチルジメトキシシラ ン,t-ブチルエチルジメトキシシラン,ジシクロペン チルジメトキシシラン、ジシクロヘキシルジメトキシシ ラン,ジ (2-メチルシクロペンチル) ジメトキシシラ ン,ジ (3-メチルシクロペンチル) ジメトキシシラ ン, ジ (2-エチルシクロペンチル) ジメトキシシラ

ン, ジ(2, 3 ジメチルシクロペンチル) ジメトキシ シラン、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキ シシラン,メチルトリエトキシシラン,エチルトリエト キシシラン、プロピルトリエトキシシラン、イソプロピ ルトリエトキシシラン,ブチルトリエトキシシラン,イ ソブチルトリエトキシシラン,t-ブチルトリエトキシ シラン, ヘキシルトリエトキシシラン, プロピルトリプ ロポキシシラン、イソプロピルトリメトキシシラン、ブ チルルトリメトキシシラン,イソブチルトリメトキシシ ラン,t-ブチルトリメトキシシラン,ヘキシルトリメ 10 トキシシラン,ジメチルジメトキシシラン,ジエチルジ メトキシシラン,ジプロピルジメトキシシラン,ジイソ プロピルジメトキシシラン,ジブチルジメトキシシラ ン, ジイソブチルジメトキシシラン, ジー tーブチルジ メトキシシラン,メチルエチルジメトキシシラン,メチ ルーt-ブチルジメトキシシラン,トリメチルメトキシ シラン、トリエチルメトキシシラン、トリプロピルメト キシシラン,トリイソプロピルメトキシシラン,トリブ チルメトキシシラン,トリイソブチルメトキシシランな どのアルキルアルコキシシラン、シクロペンチルトリメ 20 トキシシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、ジ シクロペンチルジメトキシシラン、シクロヘキシルトリ メトキシシラン,ジシクロヘキシルジメトキシシランな どのシクロアルキルアルコキシシラン、フェニルトリメ トキシシラン,フェニルトリエトキシシラン,ジフェニ ルジメトキシシランなどのフェニルアルコキシシランを 挙げることができる。また、メチルシクロペンチルジメ トキシシラン,メチルシクロヘキシルジメトキシシラ ン、t-ブチルシクロペンチルジメトキシシラン、t-ブチルシクロペンチルジメトキシシラン、セーブチルシ 30 クロヘキシルジメトキシシラン、シクロペンチルシクロ ヘキシルジメトキッシシランなども挙げることができ る。これらの中では、ジシクロペンチルジメトキシシラ ン, t-ブチルシクロペンチルジメトキシシラン, ジー tーブチルジメトキシシランなどが好適である。この (d)成分の有機珪素化合物は一種用いてもよく、二種 以上を組み合わせて用いてもよい。

【0078】ところで、上記チタン-マグネシウム系触媒は、上述したような固体触媒成分、有機アルミニウム化合物並びに第三成分としての電子供与性化合物からな 40 るものであるが、ここで有機アルミニウム化合物としては、前述した(C)成分としての有機アルミニウム化合物、例えば一般式(IX)で表される有機アルミニウム化合物などを挙げることができる。さらに、第三成分としての電子供与性化合物については、前述した固体触媒成分における(c)成分の電子供与性化合物と同様な化合物を挙げることができる。

【0079】本発明のプロピレン系共重合体(I)は、 プロピレン系グラフト共重合体(II)の前駆体でもあって、反応工程〔1〕、すなわち、前記重合触媒の存在 下、前述のプロピレンとジオレフィンとを重合させる工 程により得られる。この際、重合触媒としては、共重合 体中に観測されるビニル基と炭素一炭素二重結合の総和 と極限粘度の積関係などが特定されたプロピレン系共重 合体(1)が得られるように、前述した重合触媒の中か ら適宜選択して用いられる。この反応工程〔1〕におい ては、ジオレフィンを用いることにより、炭素=炭素不 飽和基の導入と橋かけ反応を起こさせ、さらにはジオレ フィン由来の炭素-炭素二重結合残基を有し、またオレ フィン活性末端に由来する末端ビニル基などの不飽和基 の生成反応を進行させる。プロピレンとジオレフィンと の仕込み割合については、ジオレフィン/プロピィンモ ル比が、通常1/106~102/1、好ましくは1/ 10~~10/1の範囲になるように両成分が用いられ る。この反応工程〔1〕におけるモノマー成分と触媒成 分との割合は、モノマー成分/(A)触媒成分モル比が 通常107 /1~10/1、好ましくは105 /1~1 02/1になるように選ばれる。また、重合圧力は、通 常常圧~30kg/cm²・Gの範囲で選ばれ、重合温 度は触媒活性が損なわれない範囲で高い方が好ましく、 通常-100~300℃、好ましくは-50~200 ℃、より好ましくは10~180℃の範囲で選ばれる。 【0080】このようにして得られた本発明のプロピレ ン系共重合体(I)は、プロピレンに由来する単位とジ オレフィンに由来する単位とからなる長鎖分岐状共重合 体であって、重量平均分子量が1500~50000 0、好ましくは2000~400000、より好ましく は3000~350000の範囲にある。なお、本発明 のプロピレン系共重合体(I)は、重量平均分子量が比 較的に低い場合であっても、プロピレン等のモノマーの グラフト重合によって、充分高分子量のグラフト共重合 体とすることができる。なお、この重量平均分子量はゲ ルパーミエーションクロマトグラフ (GPC) により**測** 定したポリエチレン換算の分子量である。該共重合体 (1)におけるジオレフィンに由来する単位含有量は0 モル%を超え、20モル%以下、好ましくは0.1~18 モル%、より好ましくは0.2~16モル%の範囲にある ことが必要である。この含有量が0モル%では橋かけ反 応やペンダント不飽和残基量が少なく、後述の反応工程 〔2〕におけるグラフト効率が低い。また20モル%を 超えると架橋反応が過度に起こり、不融化する傾向がみ られる。

【0081】該プロピレン系共重合体(I)においては、プロピレンに由来するビニル基とジオレフィンに由来する炭素一炭素二重結合の和〔C〕(モル%)と135℃、デカリン中で測定した極限粘度〔n〕(デシリットル、「g)との積が

 $0.01 \le (\eta) \cdot (C) \le 5$

を満足することが必要である。この〔n〕・〔C〕が0. 50 01未満では、次のグラフト反応における実質的な反応 点が少なく、また共重合したジオレフィン由来の炭素 炭素二重結合も架橋反応により消失してしまっている可能性が高い。従って、次のグラフト反応を行ったとして も、充分な溶融流動の活性化エネルギーを示さず、また 相溶化剤として使用することもできない。一方、〔ヵ〕 ・〔C〕が5を超えると、グラフト反応における実質上 の反応点数が多量に存在するために、ゲル等が発生し、 好ましくない。このような観点から、好ましくは

 $0.015 \le (\eta) \cdot (C) \le 4.5$

より好ましくは

 $0.018 \le (\eta) \cdot (C) \le 4$

特に好ましくは

 $0.02 \le (\eta) \cdot (C) \le 3.5$

の範囲である。

【0082】ここで、上記プロピレン系共重合体(1) に存在するプロピレン由来の末端ビニル基、ジオレフィ ン由来の炭素-炭素二重結合は、次のようにして算出す ることができる。

(1)ジオレフィンが直鎖又は分岐の非環式ジエン化合物を用いた場合

次のような方法で赤外線吸収スペクトルの測定結果に基 づいて算出する。すなわち、プロピレン系共重合体

(I)を熱プレスにより厚さが約100μmのフィルムとし、赤外線分光光度計にて、907cm⁻¹におけるピークの透過率を測定し、文献記載の方法〔「高分子分析ハンドブック」日本分析化学会編,240頁参照〕に基づいて以下の式から求める。

(C) =1.14×1 og (I₀ /I) × (1/(D× T))

式中、各記号は次の内容を示す。

〔C〕;末端ビニル基とジオレフィン由来の炭素−炭素 二重結合の個数(個/1000炭素)

I a : ベースラインの透過率

I ;907cm⁻¹の透過率

D ; **重合体の密度**(g/c m³)

T ;フィルムの厚さ (mm)

(2)ジオレフィンが上記(1)以外のものを用いた場 へ

末端ビニル基と、ジオレフィン由来のαーオレフィン性 炭素-炭素二重結合は上記(1)のようにして算出でき 40 る。それ以外の炭素-炭素二重結合は、核磁気共鳴スペ クトルの測定により通常の方法により、主鎖の炭素原子 1000個当たり、すなわちモノマー繰り返し単位50 0個当たりの個数として算出する。このようにして算出 した測定値の和を〔C〕とする。極限粘度〔n〕は、温 度135℃、デカリン溶媒中で測定し、ハギンスの式を 用いて算出した。なお、ハギンス定数は0.35とした。

【0083】また、本発明のプロピレン系共重合体

(1)は、示差走査型熱量計(DSC)による測定にお 性が得られない。また、このプロピレン系クラフト共重いて、融点を示さないか又は特定の融点範囲にあっても 50 合体(II)は、沸騰キシレン不溶部が1%以下、好まし

44

よい。融点を示さないプロピレン系共重合体(1)は、 プロピレン連鎖の立体規則性を示さないアタクチック構 造のものである。また、特定の融点範囲を示すプロピレ ン系共重合体(1)は、プロピレン連鎖の立体規則性が アイソタクチック構造のものである。アタクチック構 造、アイソタクチック構造の選択は、耐熱性や柔軟性の 観点から要求に応じて行うことができる。耐熱性が要求 される場合は、アイソタクチック構造が有利であり、示 差走査型熱量計 (DSC) で測定した融点が50~16 10 5℃の範囲にあることが好ましい。50℃未満では充分 な耐熱性が発現せず、165℃を超えるのは未だ技術的 に困難である。この融点は以下のようにして測定する。 すなわち、示差走査型熱量計(パーキンエルマー社製 DSC7)を用いて、あらかじめ試料10mgを窒素雰 囲気下230℃で3分間溶融した後、10℃/分で0℃ まで降温する。更にこの温度で3分間保持した後、10 ℃/分で昇温させて得られた融解吸熱カーブの最大ピー クのピークトップを融点とした。また、本発明のプロピ レン系共重合体(I)は、プロピレンを除く炭素数2~ 20 2.0 のα-オレフィン、環状オレフィン及びスチレン系 単量体に由来する単位の含有量が、全体の50モル%以 下、好ましくは0~4.0モル%である。 ここで、 5.0モ ル%を超えると共重合体中のビニル基含有量が低下し、 グラフト効率を低下せしめるという問題がある。

【0084】一方、本発明のプロピレン系グラフト共重 合体(II)は、反応工程〔2〕、すなわち、前記反応工程 [1]で得られたプロピレン系共重合体(I)に前記重 合触媒の存在下、さらに炭素数2~20のαーオレフィ ン、環状オレフィン及びスチレン系単量体の少なくとも 30 1種を共重合 (グラフト重合) させる工程により、得ら れる。なお、プロピレン系共重合体(I)を分離せず、 反応工程〔1〕と〔2〕とを連続して行う場合には、重 **合触媒を新たに加えなくてもよい。ここで、プロピレン 系共重合体(I)と共重合(グラフト重合)させるモノ** マーとしては、前述の如く、炭素数2~20のαーオレ フィン、環状オレフィン及びスチレン系単量体の少なく とも1種であるが、その中でプロピレンが最も好まし い。なお、この炭素数2~20のαーオレフィン、環状 オレフィン及びスチレン系単量体の具体例については、 すでにプロピレン系共重合体(I)の説明で言及したも のと同様である。

【0085】ところで、本発明のプロピレン系グラフト共重合体(II)におけるプロピレン系重合体(I)セグメントの含有量は、0.01~80重量%、好ましくは0.1~70重量%、より好ましくは0.5~65重量%の範囲にあるのが望ましい。この含有量が80重量%を超えるとグラフト部が少なく、目的とする加工特性が得られないし、また、0.01重量%未満では目的とする加工特性が得られない。また、このプロピレン系グラフト共重会体(II)は、速騰キシレン不溶部が1%以下、好まし

くは0.8%以下であり、またゲルを実質的に含有しない ものである。ここで、沸騰キシレン不溶部とは、ソック スレー抽出法により、微細化したプロピレン系グラフト 共重合体をキシレンで8時間抽出し、沪紙上に残存した 残存物の重量の百分率で表される。さらに、反応工程 [2]で生成した共重合体連鎖は、13C-NMR構造解 析の結果、高度のランダム性を有する。融点とコモノマ 一含量との関係は、従来のプロピレン系共重合体と異な り、少量のコモノマー含有量で融点の低下割合が大き

【0086】本発明においては、上記プロピレン系共重 合体(I)及びプロピレン系グラフト共重合体(Ⅱ) を、より熱安定性に優れたものにするために、水素添加 処理することもできる。本発明においては、好ましいプ ロピレン系グラフト共重合体(II)として、プロピレン に由来する単位の含有量が、60~99.99モル%のプ ロピレン系グラフト共重合体であって、密度が、0.80 ~0.95g/cm³ の範囲にあり、かつ結晶化エンタル ピーが20J/g以上であるものを挙げることができ る。該密度は、1ープテンや1ーオクテンなどのαーオ 20 レフィンに由来する単位の含有量、プロピレン系共重合 体(I)の密度や含有量によって、前記範囲を広い範囲 にわたってコントロールすることができる。該結晶化工 ンタルピーはコモノマー単位含有量の増加により低下 し、また、プロピレン系共重合体(I)の結晶性の有 無、その程度及び共重合体(1)の含有量によってコン トロールすることができる。なお、この結晶化エンタル ピーは、190℃でプレスしたシートを150℃で5分 間溶融した後、10℃/分の速度で−50℃まで降温し たときにみられる結晶化の発熱ピークを示差走査熱量計 30 により測定し、結晶化ピークの面積より算出した値であ

【0087】また、本発明のプロピレン系グラフト共重 合体(II)は、溶融流動の活性化エネルギー(E a)が 8~25kcal/モルの範囲にあり、かつ熱重量分析 によって得られる空気中での5%重量減少温度が300 ℃以上、好ましくは310℃以上であるものが望まし い。該溶融流動の活性化エネルギー(Ea)について は、任意にコントロールすることによって、射出成形か らブロー成形、フィルム成形まで、加工特性を付与でき るのでEaは極めて重要な指標である。なお活性化エネ ルギー (Ea) は、次のようにして算出することができ る。すなわち、測定温度150℃,170℃,190 ℃,210℃,230℃における動的粘弾性の周波数依 存性 (10-2~102 rad/sec) を測定し、17 0℃を基準温度にして、温度・時間換算則を用い、それ ぞれの温度におけるG', G"のシフトファクターと絶 対温度の逆数からアレニウス式により活性化エネルギー (Ea) が算出される。

【0088】また、熱安定性については、一般に炭素- 50 実施例1

炭素不飽和基を有する重合体は熱安定性が低く、成形加 工性に劣り、さらに耐侯性も低下し、複雑な添加剤処方 が必要であるが、本発明のプロピレン系グラフト共重合 体 (II) では、5%重量減少温度が300℃以上、好ま しくは305℃以上のものが得られ、前記問題点を解決 することができる。なお、5%重量減少温度は、空気流 量300ミリリットル/分中で10℃/分の速度で昇温 した際の5%重量減少時の温度である。上記プロピレン 系共重合体(I)は、ほぼ同等の重量平均分子量を示す 10 プロビレン単独重合体に比べて、溶融流動の活性化エネ ルギー (Ea) が充分に改善されており、加工特性に優 れている。

【0089】本発明のプロピレン系共重合体(I)及び プロピレン系グラフト共重合体(II)は、他の熱可塑性 樹脂に混合して用いることができる。他の熱可塑性樹脂 としては、例えばポリオレフィン系樹脂,ポリスチレン 系樹脂,縮合系高分子重合体,付加重合系高分子重合体 などが挙げられる。該ポリオレフィン系樹脂の具体例と しては、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、ポ リー3ーメチルー1ーブテン,ポリー4ーメチルー1ー ペンテン、コモノマー成分として1-ブテン,1-ヘキ セン、1ーオクテン、4ーメチルー1ーペンテン、3ー メチル-1-ブテンなどを用いて得られる直鎖状低密度 ポリエチレン,エチレン-酢酸ビニル共重合体,エチレ ン-酢酸ビニル共重合体けん化物,エチレン-アクリル 酸共重合体,エチレン-アクリル酸エステル共重合体, エチレン系アイオノマー、ポリプロピレンなどが挙げら れる。ポリスチレン系樹脂の具体例としては、汎用ポリ スチレン,アイソタクチックポリスチレン,ハイインパ クトポリスチレン (ゴム変性) などが挙げられる。 縮合 系高分子重合体の具体例としては、ポリアセタール樹 脂,ポリカーボネート樹脂,ナイロン6,ナイロン6・ 6などのポリアミド樹脂、ポリエチレンテレフタレー ト,ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル樹 脂、ボリフェニレンオキシド樹脂,ボリイミド樹脂,ポ リスルホン樹脂,ポリエーテルスホン樹脂,ポリフェニ レンスルフィド樹脂などが挙げられる。付加重合系高分 子重合体としては、例えば極性ビニルモノマーから得ら れた重合体やジエン系モノマーから得られた重合体、具 体的にはポリメチルメタクリレート、ポリアクリロニト リル,アクリロニトリルーブタジエン共重合体,アクリ ロニトリルーブタジエンースチレン共重合体,ジエン鎖 を水添したジエン系重合体,さらには熱可塑性エラスト マーなどが挙げられる。これらの熱可塑性樹脂の中でポ リオレフィン系樹脂が好適である。

[0090]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳しく説 明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定さ れるものではない。

プロピレン (1,9 デカジエン共重合体 (プロピレン 系共重合体 (1)) の製造

攪拌装置付き1.4リットルステンレス鋼製耐圧オートク レーブを乾燥・窒素置換した後、これに脱水トルエン4 00ミリリットル、1,9ーデカジエン15ミリモル、 トリイソブチルアルミニウム0.5ミリモル、メチルアル ミノキサン5ミリモルを投入し、500rpmで攪拌を 開始し、反応系の温度を60℃とした。次に、(1, 2'-エチレン)(2,1'-エチレン)-ビス(イン デニル) ハフニウムジクロリド $\{Et_2 (Ind)_2 H 10\}$ fCl2]のトルエン溶液をハフニウム原子換算で10 マイクロモル添加した。これにプロピレンを3kg/c m² Gで連続的に供給し、240分間共重合を実施し た。反応終了後、未反応プロピレンを脱圧により除去 し、大量のメチルアルコール中に反応混合物を投入して 触媒を失活し、分離乾燥処理してプロピレン/1、9-デカジエン共重合体37.4gを得た。この共重合体につ いて、評価を行ったところ、13C-NMRから求めた 1,9-デカジエン含有量は2.2モル%であり、プロピ レン連鎖の立体規則性はmmで78であった。また、極 20 限粘度と赤外線吸収スペクトルから求めた末端ビニル量 の積〔η〕・〔C〕は0.224であった。結果を第1表 に示す。

【0091】実施例2

プロピレン 1,9-デカジエン共重合体(プロピレン 系共重合体(I))の製造

実施例1において、1,9-デカジエン共重合体の添加量を7ミリモルとした以外は実施例1と同様に実施した。得られた共重合体について、実施例1と同様の測定を行った。結果を第1表に示す。

【0092】実施例3

プロピレンと実施例1で得られた共重合体とのグラフト 共重合体(プロピレン系グラフト共重合体(II))の製 造

機拌装置付きステンレス鋼製耐圧オートクレーブを乾燥・窒素置換した後、これに脱水トルエン400ミリリットル、実施例1で得られた共重合体3gの脱水トルエン溶液50ミリリットル、トリイソブチルアルミニウム0.5ミリモル、メチルアルミノキサン0.8ミリモルを投入し、500rpmで撹拌を開始し、反応系の温度を40 40℃とした。次に、racージメチルシランジイルービスー1ー(2-メチルー4,5ーベンゾインデニル)ージルコニウムジクロリド〔racーSiMe2 (2-Meー4,5-BenzoInd)2 ZrCl2〕のトルエン溶液をジルコニウム原子換算で0.5マイクロモル添加し、これにプロピレンを7kg/cm² Gで連続的に供

給し、60分間重合を実施した。反応終了後、未反応プロピレンを脱圧により除去し、大量のメチルアルコール中に反応混合物を投入して触媒を失活し、分離乾燥処理してプロピレン系グラフト共重合体120gを得た。このグラフト共重合体について、評価を行ったところ、13 C-NMRから求めたプロピレン連鎖の立体規則性はmmmで92.5であった。また、融点は146℃であり、沸騰キシレン不溶部はなく、溶融流動の活性化エネルギーは12.5kcal/molであった。

48

) 【0093】実施例4

(1)シラン化合物処理モンモリロナイトのトルエン懸 濁液の調製

市販のモンモリロナイト (クニミネ工業社製、クニピア F) 40gを粉砕機で4時間粉砕した。容積500ミリ リットルの三つ口フラスコに粉砕したモンモリロナイト 20gを入れ、塩化マグネシウム六水和物20gを溶解 させたイオン交換水100ミリリットルを加えて分散さ せた。攪拌下、90℃にて0.5時間処理した。処理後、 沪過して得られた固体成分を100ミリリットルの水に て3回洗浄した。この塩化マグネシウム処理及び水洗を もう一度繰り返した。次にこの固体成分を6%塩酸16 0ミリリットルに分散させ、攪拌しながら還流下、2時 間処理した。処理後、沪過して得られた固体成分に対し て、沪液が中性になるまで水洗を繰り返し、室温にて真 空間乾燥し、化学処理モンモリロナイトを得た。この化 学処理モンモリロナイト1.0gを容積300ミリリット ルのシュレンク管に入れ、トルエン25ミリリットルを 加えて分散させた。ここにメチルフェネチルシリルジク ロリド1.13g(5.2ミリモル)を加え、室温において 30 60時間攪拌後、さらに100℃にて1時間攪拌した。 攪拌終了後、静置して上澄み液を抜き出し、残った固体 成分にトルエン200ミリリットルを加えて攪拌した 後、静置して上澄み液を抜き出す操作を3回繰り返し た。得られた固体にトルエンを加えて全量を50ミリリ ットルとし、懸濁液を調製した。

(2) プロピレン/1, 9-デカジエン共重合体(プロピレン系共重合体(I))の製造

実施例1において、メチルアルミノキサン5ミリモルの 代わりに上記(1)にて得られたシラン化合物処理モン)モリロナイト懸濁液5ミリリットルを添加し、重合温度 を50℃、重合時間を300分とした以外は実施例1と 同様に実施した。得られた共重合体について、実施例1 と同様の測定を行った。結果を第1表に示す。

[0094]

【表1】

\$	1	丯
ਆ -	L	4

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	実施例1	実施例2	実施例 4
似動 (g)	3 7. 4	8 5. 0	3 5. 0
立体規則性mm (%)	7 8	8 5	7 8
1, 9-分が) 含有量(モル%)	2. 2	1. 3	2, 1
極限粘度〔η〕 (dl/g)	0.36	0. 3 2	0.40
〔C〕 (個/1000炭素)	0.62	0. 4 6	0.53
(η) · (C)	0. 2 2 4	0. 1 4 7	0. 2 1 2

[0095]

【発明の効果】以上のように、本発明のプロピレン系共 **重合体(I)やプロピレン系グラフト共重合体(II)** は、溶融体の流動の活性化エネルギーを任意に制御する ことができ、高速成形が可能で加工コストが低い上、透 明性及び均一性を有する。また、これによって、新規な* *分岐型プロピレン系共重合体やプロピレン系エラストマ ーを得ることができる。更に、本発明のプロピレン系共 重合体(I)やプロピレン系グラフト共重合体(II) は、ブロー成形やフィルム成形などにおいてゲルの発生 が少なく、高温成形に適しており、また、他の熱可塑性 樹脂に対する相溶化剤としても有用である。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J026 AA11 AA12 AA13 AA14 AA17

AA18 AA19 AA67 AA72 AC22

AC33 AC34 AC36 BA01 BA02

BA03 BA05 BB01 BB02 DA17

DA19 DB17 DB19 EA08 GA01

GA02

4J028 AA01A AA02A AB01A AC01A

AC10A AC28A BAOOA BAO2B

BBOOA BBO1B BBO2B BC01B

BCO8B BCO9B BC12B BC15B

BC25B BC32B BC40B CA30C

CB91B CB98B EB01 EB04

EB15 EB16 EB17 EB18 EB21

ECO2 ECO4 FAO2 GAO1 GA16

4J100 AA02Q AA03P AA04Q AA05Q

AA07Q AA15Q AA16Q AA17Q

AA19Q AB08Q AB09Q AB10Q

AB13Q AB15R AB16R AE81R

AE83R AR09R AR11Q AR11R

AR21R AR22R AS01R AU21R

BC21R BC22Q BC23Q BC23R

BC27Q BC27R BC36R BC37R

CA04 CA05 DA01 DA09 DA39

DA62 FA08